

การใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อเตรียมซิงค์ออกไซด์/รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์และ คอปเปอร์(II)ออกไซด์/รีดิวซ์<mark>แกรฟีน</mark>ออกไซด์เป็นวัสดุเชิงประกอบผสมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพตัวเก็บประจุยิ่งย<mark>วด</mark>

> <mark>สันติ</mark> รั<mark>ตนวีรนนท์</mark> บรรจง แก้ววิเศษกุล

สนับสนุนงบประมาณโดย <mark>มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล</mark>รัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 Efficiency Development of Hybrid Supercapacitors Using Reduced Graphene Oxide (rGO)/ZnO and Reduced Graphene Copper (II) Oxide (CuO) for High-Power Batteries

> Santi Rattanaveeranon Bunjong Keawwisutkul

Granted by Rajamangala University of Technology Rattanakosin Fiscal 2018

<mark>กิต</mark>ติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จลุล่วงจนถึงวั<mark>นนี้ได้</mark>เพราะได้รับความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลรัตนโกสินทร์ที่สนับสนุนทุนวิจัยแ<mark>ละเค</mark>รื่องมือวิจัยขั้นสูงในการศึกษาวิจัยในโครงงานจนสำเร็จลุล่วง ไปได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณคุณวรพจน์ โปร่งมณี นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้การคำปรึกษาเทคนิคต่าง ๆ ในการทำวิจัยจน โครงการวิจัยนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วย



บทคัดย่อ

รหัสโครงการ	KNO-13/25 <mark>61</mark>
ชื่อโครงการ	การใช้คลื่นไม <mark>โคร</mark> เวฟเพื่อเตรียมซิงค์ออกไซด์/รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์และ คอปเปอร์(II) <mark>ออกไซ</mark> ด์/รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์เป็นวัสดุเชิงประกอบผสมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพตัวเก็บประจุยิ่งยวดการใช้คลื่นไมโครเวฟเพื่อเตรียมซิงค์ออกไซด์/
	้ รัดวิชั่แกรฟั <mark>นออกไซด์แ</mark> ละคอปเปอร์(II)ออกไซด์/รัดวิชั่แกรฟันออกไซด์เป็นวัสดุ เชิงประกอบ <mark>ผสมเพื่อ</mark> เพิ่มศักยภาพตัวเก็บประจุยิ่งยวด
ชื่อผู้วิจัย	นายสันติ รัต <mark>น</mark> วีรนนท์
	ผู้ช่วย <mark>ศาสตราจารย์ บรรจ</mark> ง แก้ววิเศษกุล

จุดประสงค์ของโครงการนี้เพื่อนำเอาคุณสมบัติที่ดีของวัสดุประกอบผสมระหว่าง ZnO/rGO และ CuO/rGO มาประดิษฐ์เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดเพื่อใช้เป็นแบตเตอรี่ประสิทธิภาพสูง การตรวจสอบ คุณลักษณะเฉพาะของแกรฟีนออกไซด์(GO) rGO ZnO/rGO และ CuO/rGO ถูกวิเคราะห์ด้วยเครื่อง วิเคราะห์สารประกอบทางเคมี (X-ray diffractometer : XRD) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง กราด เครื่องดูดกลืนรังสีอินฟาเรด (Fourier transform infrared spectroscope : FT-IR) เครื่อง วิเคราะห์การสลายตัวเชิงความร้อน (Thermogravity analyzer : TGA) และเครื่องวัดพื้นที่ผิวจำเพาะ (Brunauer, Emmett and Teller : BET) สมบัติทางไฟฟ้าเคมีของวัสดุผสมนี้มีความจุไฟฟ้าจำเพาะ เท่ากับ ค่าความจุไฟฟ้าจำเพาะเท่ากับ 460.26±4.25 F/g ค่าความหนาพลังงานเท่ากับ 18.36 kWh/kg และค่ากำลังไฟฟ้า 25.23 kW/kg นับว่าวัสดุผสมนี้เหมาะสำหรับการผลิตเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดเพื่อ ใช้เป็นแบตเตอรี่ได้ในอนาคต

<mark>คำสำคัญ:</mark> แกรฟีนออกไซด์ รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์/ซิงอ<mark>อกไซด์</mark> รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์/คอปเปอร์ ออกไซด์ สมบั<mark>ติทางไ</mark>ฟฟ้าเคมี

E-mail Address ระยะเวลาโครงการ santi.r@rmutr.ac.th ตุลาคม 2560 – กันยายน 2562



Code of project:	Efficiency Development of Hybrid Supercapacitors Using Reduced
	Graphene O <mark>xide</mark> (rGO)/ZnO and Reduced Graphene Copper(II)
	Oxide(CuO) <mark>for H</mark> igh-Power Batteries
Research name:	Mr.Santi R <mark>attana</mark> veeranon
	Asst. Pro <mark>f. Bunjong</mark> Keawwisutkul

The purpose of this project is to bring the good features of the composite materials between ZnO/rGO and CuO/rGO to create a supercapacitor for use as a high performance battery. Detection of characteristics of graphene oxide (GO) rGO ZnO/rGO and CuO/rGO were analyzed with a chemical analysis instruments such as X-ray diffractometer (XRD) scanning electron microscope (SEM), Infrared absorption spectrometer (FT-IR) and thermal decomposition analyzer (thermogravity analyzer: TGA) and specific surface area measuring instruments (Brunauer, Emmett and Teller: BET). The electricalchemistry properties of this composite materials have a specific capacitance equal to $460.26 \pm 4.25 \text{ F} / \text{g}$. The energy density is 18.36 kWh/kg and the power value is 25.23 kW/kg. This composite materials are suitable for producing supercapacitors for use as batteries in the future.

แกรฟีนออกไซด์ รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์/ซิงออกไซด์ รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์/คอ<mark>ปเป</mark>อร์ออกไซด์ สมบัติทาง ไฟฟ้าเคมีมี

Keyword: Graphene oxide, reduce graphene oxide/zinc oxide, reduce graphene oxide/copper oxide, electrochemical

E-mail Address : santi.r@rmutr.ac.th Period of project : October 2017 - September 2019

	สารบัญ	
		หน้า
บทคัดย่	อภาษาไทย	ก
บทคัดย่	อภาษาอังกฤษ	ข
กิตติกรร	รมประกาศ	ନ
สารบัญ		গ
สารบัญ	ตาราง	ຉ
สารบัญ	รูป	જ
บทที่ 1	บทนำ	1
	1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
	1.2 วัตถุประสงค์ของกา <mark>รโครง</mark>	5
	1.3 ขอบเขตของโ <mark>ครงการ</mark>	5
	1.4 ประโยชน์ที่ <mark>คาดว่าจะได้รับ</mark>	6
	1.5 การดำเนินงานของโครงการ	6
	1.6 ระยะเว <mark>ลาในการด</mark> ำเนินงานโ <mark>ค</mark> รงการ	6
บทที่ 2	ทฤษฎีและงา <mark>นวิจัยที่เ</mark> กี่ยวข้อ <mark>ง</mark>	8
	2.1 ทฤษฎีที่เกี่ย <mark>ว</mark> ข้อง	8
	2.7 ก <mark>ารทบทวนวรรณ</mark> กรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง	16
บทที่ 3	ขั้นตอนการดำเนินการ	28
	3.1 วิธีการเ <mark>ตรียมส</mark> ารตัวอย่าง	28
	3.1.1 วิธีการสังเคราะห์แกรฟีนออกไซด์	29
	3.1.2 วิธีการสั <mark>งเคราะห์วั</mark> สดุรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์	29
	3.1.3 วิธีการสังเคราะห์วัสดุผสมรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์/ซิงค์ออกไซด์อนุภาคระดับ	30
	นาโนเมตร	
	3.1.4 วิธีการสังเคราะห์วัสดุผสมคอปเปอร์ออกไซด์/รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์	31
	3.1.5 การเตรียมฟิล์มบางชั้นแอคทีฟ (active film layer)	33
	การ <mark>เตรียมฟิ</mark> ล์มบนขัวไฟฟ้า (แผ่นสแต <mark>นเลส)</mark>	
	การ <mark>ศึกษาพฤ</mark> ติกรรมทางไฟฟ้า (electrochemistry) ของสารตัวอย่างเมื่ออยู่สารละลาย	J 35
	อิเล็กโทรไลท์	
	3.2 สถานที่ทำการทดลอง	35
บทที่ 4	ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการทดลอง	36
	4.1 การศึกษาหมู่ฟังก์ชันแกรฟีนออกไซด์ รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ วัสดุคอมโพสิต	36
	ZnO/rGO และ CuO/rGO	

4.2 การศึกษาองค์ประกอบของ <mark>โลห</mark> ะออกไซด์-แกรฟีนด้วยเทคนิคการสลายเชิงคว	ามร้อน 36
4.3 ผลการตรวจวัดคุณลักษณ <mark>ะเฉพา</mark> ะของแกรฟีนออกไซด์	37
4.4 การศึกษาสารประกอบทา <mark>งเคมีแ</mark> ละความเป็นผลึกด้วยเทคนิค XRD	37
4.5 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าเ <mark>คมี</mark>	37
บทที่ 5 การอธิบายผลและข้อสรุป	41
5.1 การอธิบายผลและข้อสรุป ประ	41
5.2 ข้อเสนอแนะ	44
บรรณานุกรม	46
ประวัติผู้วิจัย	53
ภาคผนวก	54
ภาคผนวก ก	55
ภาคผนวก ข	58

<mark>ส</mark>ารบัญตาราง

ตาร	รางที่	หน้า
1.1	ระยะเวลาในการศึกษาโครงการ	6
2.1	การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเท <mark>ศ (inf</mark> ormation) ที่เกี่ยวข้อง	15
4.1	ี แสดงค่าพื้นที่ผิวจำเพาะ ค่าคว <mark>ามจุไฟฟ้าจำเ</mark> พาะ ค่าความหนาพลังงาน และค่ากำลังไฟฟ้า	40
5.1	แสดงหมู่ฟังก์ชันที่เตรียมได้	41
1	แสดงข้อมูลดิบของการวัดไฟฟ้าเค <mark>มีของสา</mark> รตัวอย่าง	55



สารบัญรูป

รูปที่		หน้า
1.1	กราฟของราโกเนเปรียบเทีย <mark>บค่าค</mark> วามหนาแน่นกำลังงานและความหนาแน่น พลังงานของตัวเก็บพลังงานช <mark>นิดต่</mark> างๆ	2
2.1	(a) รูปวาดและภาพถ่ายแส <mark>ดงลัก</mark> ษณะทางกายภาพของแกรไฟต์และแกรฟีน (b) โครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลของแผ่นแกรฟีนที่ถ่ายจากกล้อง scanning tunnelling microscope, SEM (c) โครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลของรังผึ้ง (d) ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของแกรฟีน (e) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่อง ผ่าน (transmission electron microscope, TEM) ของแกรฟีน	7
2.2	(a) และ (b) ภาพถ่ายของสารละลายแกรฟี่นออกไซด์ที่ความเข้มข้นต่างๆ กัน (c) ภาพจากatomic force microscope, AFM, แสดงลักษณะของแผ่นแกรฟีนตาม ภาพ height image	9
2.3	(a) ภาพถ่ายของสารละลายแกรฟีนออกไซด์ (b) ภาพถ่ายจากกล้อง transmission electron microscope, TEM, ของแกรฟีน (c) และ (d) ภาพจาก atomic force microscope, AFM, แสดงลักษณะของแผ่นแกรฟีนตาม height image โดยกราฟ ด้านล่างของแต่ละภาพแสดง height profile ของแผ่นแกรฟีนตามเส้นสีดำที่ลาก ผ่านซึ่งพบว่ามีความหนาของแกรฟีนประมาณ 1-2 nm	10
2.4	(a) แ <mark>ละ (b) แสดงเส้นสเปกตราที่ได้</mark> จาก R <mark>aman spect</mark> roscopy ของแกรฟีนและ แกรไฟต์ที่มีจำนวนชั้นของแกรฟีนที่แตกต่างกัน (a) ในช่วงสแกน 1250-1650 cm ⁻¹ และ (b) ในช่วงสแกน 2500-2800 cm ⁻¹	10
2.5	(a) ภาพถ่ายแสดงการสังเคราะหแกรฟีนด้วยการใช้สก็อตเทป (b) ภาพถ่ายจาก กล้องจุลทรรศน์ของแกรไฟต์ที่มีจำนวนชั้นของแกรฟีนที่ต่างกันและแกรฟีนซึ่ง สามารถคัดแยกความหนาของแกรฟีนได้ดีสีที่เห็น	11
2.6	(a) และ (b) ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ที่เตรียมด้วยวิธีการปลูกแกรฟีน (c) ภาพจาก AFM แสดงลักษณะของแผ่นแกรฟีนตาม height image ลูกศรสีขาวแสดงรอยต่อ ของแผ่น แกรฟีนแต่ละแผ่นที่โตขึ้น (d) ภาพถ่ายของฟิล์มแกรฟีนบนกระจกสไลด์ แสดงถึงความโปรงใส	12
2.7	แส <mark>ดงตัวอ</mark> ย่างการปลูกผลึกของอนุภาค Bi ลงบนแผ่ <mark>นริดิวซ์แ</mark> กรฟีนออกไซด์เพื่อใช้ เป็นวัสดุว่องไวในการตรวจปริมาณไอเคมีของไฮดราซีน	13
2.8	ตัวอย่า <mark>งไซคลิกโวลแทมเมตทรีที่สังเคราะห์ขึ้นตามลำดั</mark> บ (ก) การเรียงตัวข <mark>อ</mark> ง คาร์บอนแบบมีลำดับชั้นและ (B) MnO₂/C-240 ที่อัตราการสแกนต่างๆตั้งแต่ 2 ถึง 100 mVs ⁻¹ ที่แรงดันตัดเป็น 1.0 และ 0.0 V เทียบขั้วไฟฟ้า SCE	14
2.9	ตัวอย่างกัลวานอสเต <mark>ติคของ MnO₂/C-240 ที่มี</mark> แรงดันไฟปิด 1.0 และ 0.0 เทียบกับ SCE ที่ความหนาแน่นของกระแสต่างๆตั้งแต่ 0.2 ถึง 5.0 Ag ⁻¹ เทียบขั้วไฟฟ้า	15

3.1	แสดงการผสมระหว่างกรดซัล <mark>ฟิว</mark> ริกเข้มข้นกับโซเดียมไนโตรทแกรไฟต์และผง โปรแทสเซียนปอร์แบงกาเน <mark>ส (ใน</mark> ice bath)	28
32	รูประกอบของของแลงการเล่า (La ICC Datin) การเกิดปกิกิริยาออกซิเดชับเรียงว่างแงแกรไฟต์กับกรดซัลฟิวริกเข้าเข้ากับโซเดียบ	29
5.2	ไปโตรทและผงโปรแทสเซียบเปลร์แบงกาเบส	27
33	แสดงการเตรียบรีดิาซ์แกรพีบออกไซด์ด้ายาิธีการรีฟลักซ์เป็บเาลา 12 ชั่าโบง	30
3.0	การเตรียงติงค์ออกไซด์/รีดิ <mark>าซ์แกร</mark> ฟีบออกไซด์ด้ายคลึ่นไปโครเาฟ	31
3.4 3.5	แสดงการกรองสารตัวอย่างด้วยเครื่องกรองสถายากาศ	31
3.6		32
3.7	แสดงการกรองสารตัวอย่า <mark>งด้วยเครื่</mark> องกรองสถายากาศ	32
3.8	แสดงรงไต้วอย่างขั้าไฟฟ้าที่ใช้ในการวิจัยบี้ a) ขั้าไฟฟ้าที่ใช้ทดลอง b) ขั้าไฟฟ้า	33
5.0	แกรซซีคาร์บอนที่เคลื่อบด้วยวัสดว่องไว (active material)	55
39	แสดงราไต้วอย่างการเคลือบด้วยฟิล์ม a) ZnO/rGO NPs และ b) CuO/rGO แต่ละ	34
5.7	พิ้ม	51
3.10	รัฐ แสดงตัว <mark>อย่</mark> างตัวเก็บประจไฟฟ้ายิ่งยวดต้นแบบ	35
4.1	แสดงหม่ฟังก์แกรฟีนออกไซด์ รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ วัสดดคอมโพสิต ZnO/rGO	36
	และ CuO/rGO	
4.2	แสดงองค์ประกอบของโลหะออกไซด์-แกรพีนด้วยเทคนิคการสลายเชิงความร้อน	36
4.3	a) รี <mark>ดิวซ์แกรฟีนออ</mark> กไซด์กำลังขยาย 30000 เท่า b) รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์	37
	ก่ำลัง <mark>ขยาย 30000</mark> เท่ <mark>า c) การ</mark> ปล <mark>กผลึกคอปเปอ</mark> ร์ออกไซด์บนแผ่นรีดิวซ์แกรฟัน	
	ออกไซด์ d) การปลูกผลึกซิงค์ออกไซด์บนแผ่นรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์	
4.4	แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์กับความเข้มรังสีเอกซ์เพื่อยืนยัน	37
	สารประกอบในสารตัวอย่าง	
4.5	แสดงกราฟไซคลิกโวลทาแกรมของวัสดุคอมโพสิต GO, rGO, ZnO/rGO และ	38
	CuO/rGO	
4.6	แส <mark>ดงควา</mark> มมีเสถียรภาพของกราฟไซคลิกโวทาแกรมในช่วงความต่างศักย์ของตัวเก็บ	38
	ป <mark>ระจุไฟ</mark> ฟ้ายิ่ง <mark>ยวด Cu</mark> O/rGO และ ZnO/rGO ชนิดตั <mark>วเก็บป</mark> ระจุไฟฟ้ายิ่งยวดแบบ	
	ลูกผสม	
4.7	้ แ <mark>สดงการ</mark> ชาร์จ ประจุและการคายประจุของตัว ต้นแ <mark>บบตัวเก็บปร</mark> ะจุไฟฟ้ายิ่งยวด	39
	CuO/rGO และ ZnO/rGO ชนิดตัวเก็บประจุไฟฟ้ <mark>ายิ่งยวด</mark> แบบลูกผสมซึ่งแปรค่า	
	ความ <mark>หนาแน่นกระไฟฟ้า</mark> ที่ป้อนให้กั <mark>บตัวเ</mark> ก็บปร <mark>ะจุต้นแบบ</mark>	
4.8	แส <mark>ดงความมีเสถียรภาพของวัสดุคอมโพสิตCuO/rGO และ</mark> ZnO/rGO ชนิดตัวเก็บ	39
	ประจุไฟฟ้ายิ่งยวดแบบลูกผสม	

ซ

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญ

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดิบถึง 816 พัน บาร์เรล/วัน [1] ซึ่งพลังงานฟอสซิลนี้จะก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและการขาดแคลนน้ำมันจากฟอสซิลทำให้ ภาครัฐหันไปสนใจพลังงานทางเลือกที่ยั่งยืน ลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่สิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก เพื่อนำพลังงานทางเลือกเหล่านั้น มาใช้จำเป็นต้องมีตัวเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเก็บพลังงานมาใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และไม่มีลม เป็นต้น ตัวเก็บพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อเก็บพลังงานมาใช้ในช่วงเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ และไม่มีลม เป็นต้น ตัวเก็บพลังงานชนิดตัวเก็บ ประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด มีข้อดีเหนือกว่าแบตเตอรี่ คือ สามารถบรรจุและคายพลังงานได้อย่างรวดเร็วในบทความนี้จะเปรียบเทียบคุณสมบัติ และกลไกการเก็บ พลังงานของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดกับตัวเก็บพลังงานชนิดอื่น ความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและ พัฒนาของไทยเทียบกับต่างชาติและมูลค่าเชิงพาณิชย์ของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด เช่น แกรฟีน แมงกานีสออกไซด์ และพอลิอะนิลีน ที่กำลังได้รับความสนใจ และถูกใช้เป็นขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ ไฟฟ้ายิ่งยวด

<mark>้เพื่อแก้ไขข้อจำกัดดังกล่า</mark>ว <mark>ตัวเ</mark>ก็บปร<mark>ะจุไฟฟ้าเคมียิ่</mark>งยวดได้รับความสนใจจากประชาคม ้ วิจัยเป็นอย่างมาก <mark>เพราะสาม</mark>ารถเก็บพลังงานต่<mark>อหน่วยน้ำหนักขอ</mark>งตัวเก็บประจุได้สูง เนื่องจากเก็บประจุ ้ไฟ<mark>ฟ้าเคมีที่พื้นผิวของวัสดุที่ใช้ทำขั้วไฟฟ้าของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด นอก</mark>จ[้]ากนั้นอายุการใช้งาน ้ขอ<mark>งตัว</mark>เก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดยังยาวนานกว่าแบตเตอรี่ เนื่องจากในการบรรจุพลังงานแต่ละครั้งไม่มี ้<mark>ปฏิกิริย</mark>าเคม<mark>ีข้างเคียงเกิดขึ้น</mark> อีกทั้งอัตราเร็วในการบรร<mark>จุพลังงาน และค</mark>ายพลั<mark>งงานของ</mark>ตัวเก็บประจุไฟฟ้า <mark>้เคมียิ่งยวดยังสูงกว่าแบต</mark>เตอรี่อีกด้วยเพราะว่าไม่ขึ้นกับจ<mark>ลนศาส</mark>ตร์ของปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี [2] รูปที่ 1 <mark>เปรียบเทียบความหนาแน่นกำลังงาน</mark> (Power density) และความหนาแน่นพลังงาน (Energy density) ้ข<mark>องอุปกรณ์ตัวเก็บพลังงานชนิดต่างๆ</mark> [3] พบว่า<mark>ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวดจะมีค่าความ</mark>หนาแน่นกำลัง ้งานสูงกว่าเซ<mark>ลเชื้อเพ</mark>ลิงและแ<mark>บตเตอ</mark>รี่ โดยเซลเชื้อเพลิงถือเป็นอ<mark>ุปกรณ์ที่</mark>สามารถเปลี่ยนพลังงานเคมีที่เก็บ ้ไว้ในพันธะเค<mark>มีของเชื้</mark>อเพลิงไปเป็นพลังงานไฟฟ้าอาศัยการเกิด<mark>ปฏิกิริย</mark>าเคมีของเชื้อเพลิงบนผิวหน้าของ ้ตัวเร่งปฏ<mark>ิกิริยาที่เป็นของแข็ง [4, 5] เมื่อพันธะเคมีของ</mark>โมเลก<mark>ุลเชื้อเพลิง</mark>แตกออกให้อิเล็กตรอนหรือ พลังงานไฟฟ้า โ<mark>ดยข้อดีของเซลเซื้อเพลิงคือมีความหนาแน่นของพลังงาน</mark>สูงสุด เมื่อเที<mark>ยบกับอุปกรณ์ตัว</mark> ้เก็บพลังงาน<mark>ชนิดอื่น แต่อย่างไรก็ตา</mark>มการทำใ<mark>ห้พันธะเคมีของโมเล</mark>กุลเชื้อเพลิงแตกอ<mark>อ</mark>กจะต้องใช้ตัวเร่ง ้ปฏิกิริยา เช่น โลห<mark>ะ พลาทินัม ที่มีราคาแพงและจลนศาสตร์ของ</mark>ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นบนผิวของตัวเร่ง ้ปฏิกิริยาค่อนข้างช้า ส่<mark>งผลให้ความหนาแน่นของกำลังงาน</mark>ต่ำ ส่งผลให้การนำเซ_ิลล์เชื้อเพลิงมาใช้เชิง พาณิชย์ยังไม่คุ้มค่า และไม่แพร่หลายมากนัก



รูปที่ 1.1 กราฟของราโก<mark>เนเปรียบเทียบค่า</mark>ความหนาแน่นกำลังงานและความหนาแน่น พลังงาน<mark>ของตัวเก็บพลังงานชนิดต่างๆ</mark> [2]

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่เก็บพลังงานโดยอาศัยปฏิกิริยารีดอกซ์ เช่น ลิเทียมไอออนแบตเตอรี่ เมื่อ บรรจุพลังงาน ปฏิกิริยารีดักชันจะเกิดขึ้นโดยลิเทียมไอออนที่อยู่ในผลึกของโลหะออกไซด์ เช่น โคบอล ออกไซด์ เป็นต้น จะรับอิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะลิเทียมในขั้วไฟฟ้าของแกรไฟต์ เป็นต้น ในขณะที่การ คายพลังงานจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน คือ โลหะลิเทียมสูญเสียอิเล็กตรอนกลายเป็นลิเทียม ไอออน กลับไปยังขั้วไฟฟ้าที่มีโลหะออกไซด์อยู่ถึงแม้ว่าแบตเตอรี่จะให้ความหนาแน่นพลังงานสูงแต่ความ หนาแน่นกำลังงานยังค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้ใช้เวลาในการบรรจุพลังงานช้า เพราะจลนศาสตร์ของปฏิกิริยารี ดอกซ์ที่เกิดขึ้นยังค่อนข้างช้านอกจากนั้นแบตเตอรี่ยังมีเสถียรภาพต่ำ บ่อยครั้งพบปัญหาการระเบิดของ แบตเตอรี่ [6]

ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดเป็นที่รู้จักกันในนามตัวเก็บประจุเคมีไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เก็บพลังงาน ไฟฟ้าเคมีสำหรับการใช้งานในระบบสำรองพลังงาน, อุปกรณ์แฟลชกล้องถ่ายรูป, อุปกรณ์พกพาสำหรับ ผู้บริโภคและรถยนต์ไฟฟ้า/ไฮบริด[1-4] ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความพยายามในการวิจัยจำนวนมากได้รับ การชี้นำให้พัฒนานาโนสถาปัตยกรรมของวัสดุสำหรับตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็น เอกลักษณ์ของพวกมันเช่นพื้นที่ผิวจำเพาะสูง ความจุในตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็น เอกลักษณ์ของพวกมันเช่นพื้นที่ผิวจำเพาะสูง ความจุในตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็น เอกลักษณ์ของพวกมันเช่นพื้นที่ผิวจำเพาะสูง ความจุในตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็น เอกลักษณ์ของพวกมันเช่นพื้นที่ผิวจำเพาะสูง ความจุในตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดโดยอาศัยคุณสมบัติที่เป็น เก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดเสมือน (pseudocapacitance) วัสดุคาร์บอนพื้นฐาน เช่น ถ่านกัมมันต์, คาร์บอน นาโนทิวบ์, และแกรฟัน) ได้รับการยอมรับว่าเป็นวัสดุที่มีแนวโน้มสำหรับตัวเก็บประจุสองชั้นด้วยไฟฟ้า เคมีเนื่องจากมีต้นทุนต่ำ [7, 10] แต่มีความจุต่ำ จึงใช้โลหะออกไซด์บางชนิดผสมเข้าไปเช่น RuO₂ และ IrO₂ ของวัสดุออกไซด์ของโลหะมีตระกูลถูกใช้เป็นวัสดุอิเล็กโทรดแบบตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดเสมือนที่มี ประสิทธิภาพที่น่าทึ่ง [11, 12] อย่างไรก็ตามการใช้โลหะดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายสูง (RuO₂ และ IrO₂) จะคอย ขัดขวางการใช้งานที่กว้างขวาง ดังนั้นจึงมีความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเร็วๆ นี้มุ่งเน้นไปที่การ เปลี่ยนแปลงโลหะออกไซด์ราคาถูกเช่นนิกเกิลออกไซด์ (NiO) [13], โคบอลต์ออกไซด์ (Co₃O₄) [14], วาเนเดียมออกไซด์ (V₂O₅) [15], แมงกานี<mark>ส</mark>ออกไซด์ (MnO₂) [16] และคอปเปอร์ออกไซด์ (CuO) [17] อย่างไรก็ตามขนาดเล็กของโครงสร้างนาโนไม่เหมาะสำหรับการแพร่กระจายของไอออนที่ถูกละลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการใช้ความหนาแน่นกระแสโหลดขนาดใหญ่ ดังนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดไม่สามารถใช้ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะที่วัสดุในกลุ่มเมโซพอรัส (Mesoporous > 2 nm) เป็นที่นิยมสำหรับ การแพร่กระจายของไอออนด้วยความเร็วสูงในรูพรุนดังกล่าว ซึ่งจะให้ความหนาแน่นกระแสโหลดสูง จากนั้นก็ยังคงเป็นความท้าทายในการสังเคราะห์โครงสร้างนาโนออกไซด์ของโลหะทรานซิชันสำหรับ ตัว เก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดที่มีสัณฐานวิทยาแบบเมโซพอรัส

การใช้โลหะอนุภาคระดับน<mark>าโนเมตรทำให้</mark>สมบัติทางกายภาพดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสมบัติทางแสง ้สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติเป็นตัวเร่ง<mark>ปฏิกิริยาทางไฟฟ้า</mark>เคมี (electrocatalytic) สมบัติเหล่านี้สามารถทำให้ ้ศักยภาพทางด้านไฟฟ้าเคมีด้าน<mark>เซ็นเซอร์ (sensor) แล</mark>ะด้านไบโอเซ็นเซอร์ (biosensor)ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ ตามโลหะอนุภาคร<mark>ะดับนาโนเมตรที่อยู่เดี่ยวไม่มีความเสถียร</mark>บนขั้วไฟฟ้า ดังนั้นจึงมีการพัฒนาวิธีการต่าง เพื่อให้โลหะระดับน<mark>าโนเมตรที่เตรียมได้มีความเสถียรเพื่อสมบัติ</mark>ทางไฟฟ้าดีขึ้น ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ้ ได้มีการใช้คาร์บอนนา<mark>โนทิวบ์เป็</mark>นฐานรอ<mark>งให้โลหะระดับนาโนไ</mark>ด้เกาะยึด เมื่อเร็วๆนี้แกรฟีนเป็นวัสดุนาโน ้สองมิติ (2D-nanomaterial) ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นแผ่นบ<mark>างของค</mark>าร์บอนอะตอม เป็นวัสดุที่มีสมบัติทางไฟฟ้า ้ที่เคมีที่ดีเยี่ยมซึ่<mark>งได้รับความสนใจอย่างมาก ส</mark>มบัติหนึ่งของแกรฟ<mark>ีนค</mark>ือมีพื้นที่ผิวสูงมาก(เปรียบเทียบกับ ้คาร์บอนนาโนทิ<mark>วบ์) ดังนั้นแก</mark>รฟ<mark>ีนซึ่งอยู่ก</mark>ลุ่ม<mark>ตร</mark>ะกูล<mark>คาร์บอนจึงเ</mark>ป็นวัสดุที่เหมาะสมอย่างยิ่ง (วัสดุที่มี ้คว<mark>ามเสถียรสูง) ในการป</mark>ลูกผลึกโลหะอนุภาคนาโนเมตรบนพื้นผิวของแกรฟีน แกรฟีนออกไซด์ (g<mark>raphene oxide) คือหมู่อนุพันธ์ของออกซิเจนที่เกาะพื้นผิวของแกร</mark>ฟีน ถู<mark>กใช้</mark>เป็นสารตั้งตั้นของการ <mark>้ เตรียมวัสดุผสมแกรฟีน-โลหะ</mark>อนุภาคระดับนาโนเมตร <mark>ซึ่งข้อดีของการเต</mark>รียม<mark>ด้วยวิธีการ</mark>นี้คือมีค่าใช้จ่ายที่ <mark>้ไม่แพง ขั้นตอนการเตรียม</mark>ที่ไม่ยุ่งย<mark>ากซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้จะอยู่ในรูปสารละลายที่มีหมู่ฟังก์ชันออกซิเจนเกาะ</mark> ้อยู่ กล่าวโดยสรุปสมบัติทางไฟฟ้าของแกรฟีนสามารถควบคุมได้ง่ายด้วยอนุภาคโลหะระดับนาโนเมตรบน แผ่นแก<mark>รฟืนทำให้สม</mark>บัติทางไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมเป็นผลประสานกัน<mark>ระหว่า</mark>งแกรฟืนกับอนุภาคโลหะระดับนา โนเมตรที่ก<mark>ระจายตัว</mark>อยู่บนแผ่นแกรฟีน

ในการทบทวนวรรณกรรมในอดีต อนุภาคโลหะระดับนาโนเมตรที่นำมาปลูกผลึก ตัวอย่างเช่น ทอง (Au) เพิลเลเดียม (Pd) โรเดียม (Rh) เงิน (Ag) ทองคำขาว (Pt) คอบอลท์ (Co) เป็นธาตุที่มีราคาแพง ที่มีใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีสำหรับการออกซิเดชันของไฮดราซีน[18] บางวารสารได้นำเสนอ อนุภาคโลหะระดับนาโนเมตรที่ใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดไฮดราซีน คือ อะภาคทองระดับนาโน-คาร์บอนนาโน ทิวบ์ชนิดผนังชั้นเดียว โลหะสองชนิดระหว่างอนุภาคทอง-เพิลเลเดียมระดับนาโนเมตรบนแผ่นแกรฟีน อนุภาคโรเดียมระดับนาโนเมตรที่เกาะอยู่บนแท่งคาร์บอนไฟเบอร์ การปลูกผลึกอนุภาคทองบนคาร์บอน นาโนทิวบ์ชนิดผนังหลายชั้น การปลูกผล<mark>ึกอ</mark>นุภาคทองคำขาวบนคาร์บอนนาโนทิวบ์ อนุภาคคูบอลท์ที่มี สัณฐานเป็นรูปดอกไม้บนแผ่นแกรฟีน เ<mark>ป็นต้น</mark>

็นอกจากนี้ผลของผลประจุไฟฟ้<mark>าแบ</mark>บเสมือน (pseudocapacitance) สำหรับการปรับปรุงกำลัง การผลิตรวมของวัสดุคาร์บอนรวมกันทำ<mark>วัสดุ</mark>พอลิเมอร์ไฮบริดโดยปฏิกิริยาฟาราเดอิก (Faradaic) อย่าง รวดเร็วได้รับการตระหนักโดยการแทร<mark>กของ</mark>ออกไซด์โลหะการเปลี่ยนแปลงที่ใช้งานไฟฟ้า เช่น การใช้ ZnO Co₂O₃ RuO₂ MnO₂ TiO₂ แ<mark>ละ Fe₂O₃ เป็นต้น [6]</mark> Co₂O₃ และ ZnO เป็นออกไซด์ของโลหะ ทรานซิสชันที่รู้จักกันดี ZnO ไม่ได้มี<mark>ความสำคัญ</mark>เพียงอย่างเดียวเนื่องจากคุณสมบัติตัวเร่งปฏิกิริยาทาง อิเล็กทรอนิกส์, แสง, ไฟฟ้าและเคมี<mark>, แต่ยังมีคุ</mark>ณสมบัติทางความร้อน-ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน [7, 8] Co₂O₃-้คอมโพสิตตามได้แสดงให้เห็นถึงศักย<mark>ภาพที่ดีใน</mark>ด้านของตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดต่างกันตัวเร่งปฏิกิริยา เซ็นเซอร์ไฟฟ้าเคมีและแบตเ<mark>ตอรี่แบบลิเทียม(Li</mark>-ion) [9-13] อย่างไรก็ตาม ZnO มักจะให้อัตรา ้ความสามารถที่ไม่ดีและการพลิก<mark>กลับได้ในระหว่าง</mark>กระบวนการชาร์จจำหน่ายเนื่องจากมันเป็นผลึกขนาด ้ ใหญ่ดังนั้นการปรับเปลี่ยน<mark>คริสตัลขนาดของ ZnO และเพิ่</mark>มการนำไฟฟ้าของอิเล็กโทรดทั้งเป็นที่ต้องการ ้อย่างสูงมีความพยา<mark>ยามมากขึ้นถูกใช้เพื่อแก้ไขขนาดผลึกโ</mark>ดยกลไกการเติมและเพิ่มการนำไฟฟ้าโดยการ รวมเข้าด้วยกันพว<mark>กมันเป็นวัสดุที่มีคาร์บอนและนำโพลิ</mark>เมอร์ เช่น แกรฟินและพอลิอะนิลิน (polyaniline:PANI) ใ<mark>นปีที่ผ่าน</mark>มานักวิจั<mark>ย</mark>หลายคน<mark>สนใจกา</mark>รสังเคราะห์คอมโพสิตที่แตกต่างกันโดย ้ใช้RGO,ออกไซด์ของโล<mark>หะและ</mark>วัสดุที่<mark>ใช้ทำ</mark>จากพอ<mark>ลิอะนิ</mark>ลิน เช่น rGO–ZnO, [14] rGO–Co₂O₃ [15] Co-ZnO [16] ซัลเฟอร์-<mark>พอลิอ</mark>ะนิลิน-แกรฟีน(sulfu<mark>r-poly</mark>aniline-graphene) [17] rGO-Co₂O₃, [18] PANI-Co₂O₃, [<mark>19]</mark> rGO-SnO₂-PANI [20] rGO-Fe₂O₃-PANI [21] และPANI-TiO₂-GO [22] ใน ้บริบทนี้วัสดุ คอ<mark>มโพสิตประ</mark>กอบไ<mark>ปด้วย</mark>ส่วนประกอบที่ทำจากค</mark>าร์บอนประกอบด้วยเชื่อมประสาน ระ<mark>หว่างพอ</mark>ลิเม<mark>อร์และโล</mark>หะทรานซิชันออกไซด์ได้รับก<mark>ารศึกษาและแสดงให้เ</mark>ห็นถึงการปรับปรุงใน พฤ<mark>ติก</mark>รรมทางเคมีไฟฟ้าที่ส่งทิศทางใหม่สำหรับการผลิตของรุ่นต่อไปที่มีประสิทธิภาพสูงsupercapacitor ้<mark>อย่างไรก็ตามรายงานวรรณกร</mark>รมทั้งหมดมุ่งเน้นไปที่อ<mark>อกไซด์โลหะเดียวแ</mark>ทรก<mark>ระหว่างก</mark>ารดำเนินการวัสดุ <mark>์ โพลีเมอร์และคาร์บอนอย่างสุดความสามารถค</mark>วามรู้ขอ<mark>งเราลด แกรฟีนออกไซด์โค</mark>บอลต์ เจือ ZnO <mark>คอมโพสิตพอลิอะนิลินไฮบริดสำหรับก</mark>ารประยุกต์ใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดยังคงไม่ได้รับรายงาน

ในโครงการนี้ เป็นการพัฒนาตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดให้มีความจุไฟฟ้าสูงขึ้น การชาร์จประจุ ไฟฟ้าได้เร็วขึ้น โดยพัฒนาแบบไฮบริดจ์ลูกผสมของขั้วไฟฟ้าที่มีด้านหนึ่งเป็นขั้วของ rGO/ZnO และอีก ขั้วไฟฟ้าเป็นขั้วของ rGO/CuO ในขั้นตอนสุดท้ายจะนำเอาข้อมูลทางไฟฟ้าเคมีมาออกแบบเป็นตัวเก็บ ประจุไฟฟ้ายิ่งยวดเพื่อใช้เป็นแบตเตอรี่ใช้งานต่อไป

1.2 วัตถุปร<mark>ะสงค์ของโคร</mark>งการ

 1.2.1 เพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมวัสดุประกอบผสม เช่น ระยะเวลาใน เกิดปฏิกิริยา ปริมาณของแกรฟีนออกไซด์:ซิงค์คลอไรด์และแกรฟีนออกไซด์:คอปเปอร์ (II) คลอไรด์ เช่น ปริมาณความเข้มของซิงค์คลอไรด์ คอปเปอร์คลอไรด์ ระยะเวลาการทำเป็น ปฏิกิริยา เป็นต้น 1.1.2 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่<mark>าง</mark>ความจุไฟฟ้าจำเพาะกับค่าความศักย์และค่าการชาร์จประจุ และการคายประจุของตัวเก็บป<mark>ระจุยิ่</mark>งยวด

1.1.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมขอ<mark>งกระแ</mark>สไฟฟ้า-ความต่างศักย์ (I-V characteristic) ของฟิล์มบาง วัสดุประกอบ rGO/ZnO และ rGO/CuO อนุภาคระดับนาโนเมตรอนุภาคระดับนาโนเมตรบน ขั้วไฟฟ้าแบบ 3 ขั้ว (three electrode) และตัวเก็บประจุไฟฟ้าต้นแบบ (prototype)

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 เตรียมสารวัสดุประกอบผสมระหว่างซิงค์ออกไซด์/รีดิวซ์แกรฟีน และคอปเปอร์ (II) ออกไซด์/
 รีดิวซ์แกรฟีนวัสดุประกอบผสมระดับนาโนเมตรให้มีปริมาณมาก

1.3.2 ขึ้นรูปชิ้นงานตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดโดยนำสารในข้อ 1.3.1 มาเคลือบบนขั้วไฟฟ้าแล้วประกบ ขั้วไฟฟ้าโดยให้ด้านบนเป็นซิงค์ออกไซด์/รีดิวซ์แกรฟีนและด้านล่างเป็นคอปเปอร์(II) ออกไซด์/รีดิวซ์แก รฟีน(ใช้เยื่อเลือกผ่านไมโครไฟเบอร์เป็นตัวกั้นกลางระหว่างขั้วไฟฟ้าทั้งสอง) แล้ววัดไฟฟ้าเคมีของตัว เก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด

1.3.3 นำข้อมูลที่ได้จากข้อ 1.3.2 มาจัดทำบทความทางวิชาการระดับชาติและนำเสนอผลต่อไป

1.4 ประโยชน์ที่คาดว<mark>่าจะได้รับ</mark>

1.4.1 สามารถ<mark>ทราบเงื่</mark>อนไขที่เหม<mark>าะ</mark>สมสำหรับการสังเคราะห์วัสดุประกอบ ZnO /rGO และ CuO/rGO อนุภา<mark>คระดับ</mark>นาโนเมตรได้

1.4.2 <mark>สามารถทราบเงื่อนไขที่เหมาะส</mark>มสำหรั<mark>บการ</mark>วัดค่า<mark>ทาง</mark>ไฟฟ้าเคมีของตัวเก็บประจุไฟฟ้า ยิ่งยวดได้

1.4.3 สาม<mark>ารถนำผล</mark>งานไปเ<mark>ผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานระดั</mark>บชาติได้

1.<mark>5 การดำเนินงานของโครงการ</mark>

<mark>ในการศึกษาโครงการ มีวิธีการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้</mark>

- 1. รวบรวมข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
- 2. จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์
- จัดเตรียมตัวอย่างที่จะใช้ทดสอบ
- 4. ท<mark>ดสอบแ</mark>ละบันทึกผลการทดสอบ
- 5. วิ<mark>จารณ์ผ</mark>ลสรุปผลก<mark>ารท</mark>ดสอบ

1.6 ระยะ<mark>เวลาในการดำเนินงานโคร</mark>งการ

ระยะเวลาใน<mark>การศึกษาโรงการร</mark>วมทั้งสิ้น 1<mark>2 เด</mark>ือน <mark>ดังแสดงราย</mark>ละเอียดในตารางที่ 1.1



ตารางที่ 1.1 ระยะเวลาในการศึกษาโคร<mark>งกา</mark>ร

a */	ระยะเวลา											
กระบวนการวิจัย	ต.ค. 60	พ.ย. 60	ธ.ค. 60	ม.ค. 61	ก.พ. 61	มี.ค. 61	ເມ .ຍ . 61	พ.ค. 61	ນີ້.ຍ. 61	ก.ค. 61	ส.ค. 61	ก.ย. 61
1.ศึกษาค้นคว้าเอกสาร	< →		公室									
- วางแผนการวิจัย				AK								
 เตรียมสารละลายแกรฟีน ไดออกไซด์ให้มีปริมาณมาก เพียงพอ 		the a	Sak 1			Se la						
3.เตรียมตัวอย่างรีดิวซ์แกรฟีน ออกไซด์และสารประกอบ rGO/ZnO และ rGO/CuO อนุภาคระดับนาโนเมตร.	annad B		9) <u>a </u>		NC-98	Share S	and the second se					
4.ขั้นรูปฟิล์มบางบนขั้วไฟฟ้า แล้ววัดค่าทางไฟฟ้าเคมี (cyclic voltagram : CV, charge <mark>-discharge</mark> , EIS technique เป็นต้น)							No.					
5.ศึกษาสมบัติทางกายกาพ ของซิลิกอนไดออกไซด์ เช่น รูปผลึกของรีดิวซ์แกรฟีน พื้นที่ผิวจำเพาะ ภาพถ่าย สัณฐานของตัวอย่าง ฯลฯ								શેપ્રભાર્ક સ				
6.สรุปรายงานวิจัยฉบับ สมบรูณ์ แล้วนำผลงานไป เผยแพร่และตีพิมพ์ผลงาน ระดับนานาชาติ ฯลฯ	2						L'ége	See.				

หมายเหตุ: แผนการดำเนินงาน อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บทที่ 2 ทฤษ<mark>ฎีและ</mark>งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แกรฟีน (graphene) คือ วัสดุ 2 มิติ ที่มีการจัดเรียงตัวของอะตอมของคาร์บอนอย่างเป็นระเบียบมี โครงสร้างผลึกแบบเฮกซะโกนอล (hexagonal structure) ที่มีลักษณะคล้ายกับรวงผึ้ง ความกว้างและความ ยาวของแกรฟีนมีตั้งแต่ระดับหลายสิบนาโนเมตรจนถึงมากกว่า 1 เมตร แต่ความหนาของแกรฟีนนั้นเท่ากับ ขนาดของคาร์บอนอะตอม (ประมาณ 0.34 nm) [20] รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างจำลองของแกรฟีนและแกรไฟต์ ทั้งนี้ในแกรไฟต์ที่มีความหนาประมาณ 1 mm จะประกอบด้วยแกรฟีนมากถึงสามล้านแผ่น แกรฟีนถือว่าเป็น วัตถุ 2 มิติอย่างแท้จริงที่พบได้ในธรรมชาติ ณ เวลานี้เนื่องจากในอดีตนักวิทยาศาสตร์คาดว่าวัตถุ 2 มิติ ไม่ สามารถคงรูปการจัดเรียงของอะตอมอย่างเป็นระเบียบได้ที่อุณหภูมิห้องหรือแม้กระทั่งอุณหภูมิที่เข้าใกล้ อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ (0 K หรือ -273 °C) เพราะเมื่อวัตถุมีขนาดใหญ่การจัดเรียงอะตอมจะเสียไปและวัตถุนั้น จะหลอมเนื่องจากพลังงานความร้อนและความผันผวนทางความร้อน (thermal fluctuation)



รูปที่ 2.1 (a) รูปวาดและภาพถ่ายแสดงลักษณะทางกายภาพของแกรไฟต์และแกรฟีน (b) โครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลของแผ่นแกรฟีนที่ถ่ายจากกล้อง scanning tunnelling microscope, SEM (c)โครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลของรังผึ้ง (d) ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ของ แกรฟีน (e) ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน (transmission electron microscope, TEM) ของแกรฟีน

แกรฟินถือว่ามีแถบพลังของสารกึ่งตัวนำเป็นศูนย์ (zero gap semiconductor) ซึ่งอิเล็กตรอนบน แผ่นแกรฟินประพฤติตัวแตกต่างไปจากวัตถุอื่นๆ คือ ประพฤติตัวเป็นไปตามทฤษฎีสัมพันธ์ภาพ (relativistic behaviour) โดยอิเล็กตรอนบนแกรฟินถือว่าไม่มีมวล (massless) เนื่องจากการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนมี ความเร็วเข้าใกล้ความเร็วแสง (มีความเร็วน้อยกว่าแสงประมาณ 300 เท่า) ซึ่งอนุภาคที่ไร้มวลนั้นมีเฉพาะแสง (photon) และ นิวตริโน (neutrino) จากเหตุผลข้างต้นทำให้อิเล็กตรอนเคลื่อนที่บนแกรฟันได้ไวกว่าซิลิกอน ประมาณ 100 เท่า ที่อุณหภูมิห้อง และเนื่องจากโครงสร้างแบบเฮกซะโกนอลที่เป็นระเบียบของแกรฟันทำให้ โฟนอนสามารถเคลื่อนที่ได้ดีบนแกรฟันจึงทำให้ค่าการนำความร้อน (thermal conductivity) ของแกรฟันนั้น มีค่าประมาณ 5000 Wm⁻¹K⁻¹ ซึ่งมากกว่าท<mark>องแดง</mark>ประมาณ 10 เท่า ที่อุณหภูมิห้อง [21, 22]

แกรฟืนยังมีคุณสมบัติเชิงกลที่ดีมาก มีความคงทนต่อการแตกหัก (breaking strength) ประมาณ 42 N/m ซึ่งมากกว่าเหล็กประมาณ 100 เท่า และสามารถทนทานต่อแรงดึง (tensile strength) ได้มากถึง 130 GPa ซึ่งในทางทฤษฎีได้กล่าวว่าถ้ามีเปลนอนทำจากแกรฟืนขนาด 1mx1m แขวนอยู่ระหว่างต้นไม้สามารถนำ แมวซึ่งมีน้ำหนักประมาณ 4 kg ไปบางบนเปลนี้ได้โดยน้ำหนักของเปลนั้นน้อยกว่า 1 mg และไม่สามารถ มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเนื่องจากความหนาของเปลในระดับอะตอมทำให้มีลักษณะโปรงใส (transparency) โดยแสงในช่วงที่ตามมองเห็นสามารถส่องผ่านแกรฟืนได้มากกว่า 97% [23-26]

2.1.1 การสังเคราะห์<mark>แกรฟีน</mark>

การสังเคราะห์แ<mark>กรฟีนมี</mark>หลายวิธี แต่งานวิจัยนี้ใช้วิธีเตรียมเป็นแกรฟีนออกไซด์ ดังนั้นผู้ทำการวิจัย จะให้ความสนใจในการสังเคร<mark>าะห์แก</mark>รฟีนด้วยวิธีนี้ มากกว่<mark>าวิธีอื่น</mark>ๆ [27-31]

1 การสังเคราะห์แกรฟีนจากแกรไฟต์ด้วยวิธีโซนิเคชัน (sonication): โดยทั่วไป กระบวนการ ์โซนิเคชัน นั้นเกี่ยวข้อ<mark>งกับคลื่นอัลต</mark>รา<mark>ซาวด์ (u</mark>ltrasound) <mark>ซึ่งเป็นคลื่นเ</mark>สียงที่อยู่เหนือการได้ยินตามปรกติของ ้มนุษย์ (18,000 Hz หรื<mark>อมากกว่</mark>า) ส่วนมากที่ใช้ประมาณ 40 kHz หรือมากกว่า เมื่อคลื่นเสียงผ่านของเหลว หรือน้<mark>ำที่มีแกรไฟต์ละลายอยู่ด้วยพลังที่เหมาะสมโมเลกุลของน้ำจะเกิดการสั่นทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงกลจาก</mark> ้ความก<mark>ดอัดของของเหลวที่เปลี่ยนไปอย่างฉับพลันที่เรียกว่า การระเบิดเย็น (cavitatio</mark>n) ขบวนการนี้เกิดขึ้น ้<mark>อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องทำให้เกิดความผันผวนในของเหลวและในแกรไฟต์ทำให้เกิดการ</mark>ขัดถูและเกิดการ ้ แ<mark>ยกตัว (exfoli</mark>ation) ของแกรฟีนออกจากแกรไฟต์เนื่องจากแต่ละแผ่นของแกรฟีนที่วางซ้อนทับเรียงตัวกันเป็น ้แกรไฟต์นั้นยึดเกาะกันด้วยแรงแวนเดอร์วาลล์ (van der Waals force) ซึ่งมีค่าประมาณ 5.9 kJ/mol ดังนั้น ้ถ้าแรงเนื่อง<mark>มาจากการ โซนิเคชันจึงมากกว่าแรงแวนเดอร์วาลล์ก็จะทำให้แกรฟ</mark>ีนหลุดออก<mark>ม</mark>า ดังนั้นการหลุด ้ร่อนของแกร<mark>ฟินยังขึ้นอ</mark>ยู่กับ<mark>ชนิดของแกรไฟต์, ของเหลว, สารเคมี, ความ</mark>ถี่ของคลื่น และอุณหภูมิ อีกด้วย ้โดยทั่วไปแกรไฟ<mark>ต์ไม่สา</mark>มารถ<mark>ละลายในน้ำได้ ดังนั้น การสังเคราะห์แกร</mark>ฟีนจากแกรไฟต์ด้วยวิธีโซนิเคชัน ้จำเป็นต้องแปรสภ<mark>าพแกรไฟต์สารตั้งต้นให้เป็นแกรไฟต์ออกไ</mark>ซต์ (g<mark>raphite</mark> oxide) ก่อนเพื่อเพิ่มความสามารถ ้ในการละลายน้ำ <mark>[32-39] ซึ่ง</mark>จะทำให้กระบวนการ<mark>โซนิเค</mark>ชันมี<mark>ประสิทธิภา</mark>พในการแยกแ<mark>ก</mark>รไฟต์ได้ดีมากขึ้น ้ดังนั้นทุกงานวิจัยในปัจ<mark>จุบันที่สังเค</mark>ราะห์แกรฟีนจึงต้องแปร<mark>สภาพแกรไฟต์</mark>เป็นแกรไฟต์ออ</mark>กไซต์เสมอ แกรไฟต์ ้สามารถเปลี่ยนเป็นแกรไฟต์ออกไซด์ได้ด้วยการปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation reaction) โดยวิธี Hammer's method ซึ่งใช้สารผสมระหว่างกรดซัลฟิวริก (H₂SO₄), โซเดียมในโตรท (NaNO₃) โปแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส (KMnO₄) และ ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) จึงทำให้มีกลุ่มฟังก์ชันต่าง ๆ เกาะอยู่บนแกรฟีนออกไซด์ เช่น กลุ่มออกไซด์ (bridging oxygen atoms), คาร์บอนิล (= CO), ไฮดรอซิล (-OH) และ ฟีนิล (phenyl, C6H5) ซึ่ง กลุ่มฟังก์ชันเหล่านี้ทำให้คุณสมบัติของแกรฟินที่แท้จริงเปลี่ยนไป เช่น การนำไฟฟ้า ดังนั้นหลังจากการโซนิเค ชั้นตามระยะเวลาที่กำหนดแกรฟืนออกไซด์จะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นแกรฟืนด้วยกระบวนการรีดักซัน (reduction reaction) เช่น ใช้สารเคมี, ความร้อน หรือ แสงยูวี (UV-assisted approach) หลังจากการปั่นเหวี่ยง (centrifugation) แกรฟีนที่ผ่านการรีดักชัน (reduced graphene) มาแล้ว สารละลายแกรฟีนมีเหลืองแกม ้น้ำตาล เมื่อมีแกรฟีนละลายในน้ำด้วยความเข้มข้น 0.2 mg/ml เมื่อความเข้มข้นของแกรฟีนเป็น 2 mg/ml

สารละลายมีสีเทาดำดังรูปที่ 2 แกรฟันที่สังเค<mark>ราะ</mark>ห์ได้ถูกตรวจสอบด้วย TEM และ Raman spectroscopy ดัง รูปที่ 3 และรูปที่ 4 ตามลำดับ ซึ่งลักษณะของพีค (peak) ที่ได้จาก Raman นั้นจะแตกต่างกับของแกรไฟต์ การสังเคราะห์แกรฟันด้วยวิธีนี้เป็นวิธีทำให้ไ<mark>ด้แกร</mark>ฟีนในปริมาณมาก ซึ่งเหมาะสมในระดับการทำวิจัยและระดับ อุตสาหกรรม



รูปที่ 2.2 (a) <mark>และ (b) ภาพถ่ายของสาวสะสายแกวพันยอก</mark>เซตทศาสามเขมข้นต่างๆ กัน (c) ภาพจาก atomic force microscope, AFM, แสดงลักษณะของแผ่นแกรฟันตามภาพ height image



ร**ูปที่ 2.3** (a) ภาพถ่ายของสารละลายแกรฟีนออกไซด์ (b) ภาพถ่ายจากกล้อง transmission electron microscope, TEM, ของแกรฟีน (c) และ (d) ภาพจาก atomic force microscope, AFM, แสดงลักษณะของแผ่นแกรฟีนตาม height image โดยกราฟด้านล่างของแต่ละภาพแสดง height profile ของแผ่นแกรฟีนตามเส้นสีดำที่ลากผ่านซึ่งพบว่ามีความหนาของแกรฟีนประมาณ 1-2 nm



รูปที่ 2.4 (a) และ (b) แสดงเส้นสเปกตราที่ได้จาก Raman spectroscopy ของแกรฟันและ แกรไฟต์ที่มีจำนวนชั้นของแกรฟันที่แตกต่างกัน (a) ในช่วงสแกน 1250-1650 cm⁻¹ และ (b) ในช่วงสแกน 2500-2800 cm⁻¹

2.2 การสังเคราะห์แกรฟีนจากแกรไฟต์โดยใช้สก็อตซ์เทป(scotch tape): โดยนำชิ้น แกรไฟต์มาวางบนสก็อตเทปแล้วปิดแกรไฟต์ด้วยอีกด้านหนึ่งของสก็อตเทปแล้วค่อยๆ ดึงออกไปเลยๆ หลายๆ รอบแล้วนำแกรไฟต์นั้นไปติดบน ซิลิกอนไดออกไซด์ (SiO₂) ดังรูปที่ 5 วิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้ต้นทุนต่ำ และง่ายต่อการสังเคราะห์โดยแกรฟันที่ได้บนซิลิกอนจะมีสีม่วงเมื่อมองผ่านกล้องจุลทรรศน์เนื่องจาก การแทรกสอดของคลื่นแสง อย่างไรก็ตามวิธีนี้เหมาะสำหรับการสาธิต แต่ไม่เหมาะสำหรับในระดับ งานวิจัยหรือระดับอุตสาหกรรมที่ต้องการ แกรฟันปริมาณมากในเวลาที่จำกัด



รูปที่ 2.5 (a) ภาพถ่ายแสดงการสังเคราะหแกรฟืนด้วยการใช้สก็อตเทป (b) ภาพถ่ายจากกล้อง จุลทรรศน์ของแกรไฟต์ที่มีจำนวนชั้นของแกรฟืนที่ต่างกันและแกรฟืนซึ่งสามารถคัดแยกความ หนาของแกรฟืนได้ดีสีที่เห็น

2.3 การปลูกผลึกของแกรฟื่นแบบสลายตัวเชิงความร้อน (thermal decomposition growth): เป็นการปลูกผลึกของแกรฟื่นบนแผ่นฐาน (substrate) ที่มีโครงสร้างเป็นผลึกเชิงเดี่ยว โดยทั่วไปนิยมใช้ ซิลิกอนคาร์บายด์ (SiC) โดยการให้ความร้อนแก่ซิลิคอนคาร์ไบด์ที่อุณหภูมิ 1100 °C หรือมากกว่า [31] โดยความร้อนจะไปสลายพันธะระหว่างซิลิกอนและคาร์บอน เมื่อถูกความร้อน คาร์บอนโมเลกุลจะแพร่ออกมาที่ผิวหน้าของซิลิกอนซิลิคอนคาร์ไบด์ เกิดเป็นนิวเคลียสของแกรฟืนและ เจริญเติบโตเป็นแผ่นแกรฟืน ข้อดีของวิธีนี้คือขั้นตอนไม่ยุ่งยาก แต่ต้องใช้เตาอบที่มีอุณหภูมิสูง การเกิด ของแกรฟืนนั้นขึ้นอยู่กับอุณหภูมิดังนั้นการควบคุมอุณหภูมิจึงเป็นสิ่งสำคัญและแกรฟินที่ได้ส่วนมากจะ มีตั้งแต่ 1-10 ชั้นของแกรฟินซึ่งยังยากต่อการควบคุม

2.4 การปลูกผลึกของแกรฟืนแบบไอระเหยทางเคมี (chemical vapour deposition) : เป็นการปลูกผลึกของแกรฟืนบนแผ่นฐาน (substrate) โดยใช้แผ่นฐานเป็น ตัวเร่งปฏิกริยา (catalyst) [28] เช่น นิกเกิล (nickel) หรือใช้วัสดุอื่นบนแผ่นฐานดังรูปที่ 6 ซึ่งส่วนมากใช้ทองแดงเป็นตัวเร่ง ปฏิกริยาทั้งนี้ปฏิกริยาทั้งหมดเกิดขึ้นในรีแอกชันแชมเบอร์ (reaction chamber) ในระบบสูญญากาศ และใช้ก๊าซมีเทน (CH₄) เป็นแหล่งของคาร์บอน ข้อดีของวิธีนี้คือ สามารถสังเคราะห์แกรฟืนในปริมาณ มากแต่เป็นยังยากต่อการควบคุม โดยมักจะมีการเกิดขึ้นของแกรฟินหลายชั้นและยังมีจุดบกพร่อง (defect) ที่เกิดขึ้นระหว่างแกรฟินกับแผ่นฐานเมื่อแกรฟินถูกย้ายไปยังแผ่นฐานชนิดอื่น และยังพบว่า แกรฟินที่เกิดขึ้นยังมีรอยเ



รูปที่ 2.6 (a) และ (b) ภาพถ่ายจากกล้อง SEM ที่เตรียมด้วยวิธีการปลูกแกรฟีน (c) ภาพจาก AFM แสดงลักษณะของแผ่นแกรฟีนตาม height image ลูกศรสีขาวแสดงรอยต่อของแผ่น แกรฟีนแต่ละ แผ่นที่โตขึ้น (d) ภาพถ่ายของฟิล์มแกรฟีนบนกระจกสไลด์แสดงถึงความโปรงใส

2.5 การปลูกผลึกแกรฟินแบบการฝังไอออน (ion implantation) ที่ผิวของวัสดุ: เป็น กระบวนการใหม่ในการปลูกผลึกของแกรฟินบนผิวหน้าวัสดุ เดิมกระบวนการนี้ใช้สำหรับปรับผิวหน้าของวัสดุ ให้มีสมบัติเชิงกายภาพดีขึ้น เหมาะสำหรับนำไปใช้ในงานพิเศษด้านต่าง ๆไอออนจะฝังลึกลงไปในผิวหน้า ประมาณ 0.1 µm กระบวนการทั้งหมดดำเนินไปในห้องที่มีความดันบรรยากาศต่ำ การปลูกผลึกแกรฟินแบบ การฝังไอออนเป็นเทคนิคของการเคลือบแข็งแบบใหม่ที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว คือ เคลือบวัสดุ โดยไม่ เปลี่ยนแปลงขนาดของวัสดุนั้น, ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการติดแน่นของสารเคลือบกับวัสดุ, ไม่มีปัญหา thermal distortion ผิวขึ้นงานได้รับการขัดไปในตัว การฝังตัวของอะตอมเป็นกระบวนการระดับจุลภาค แกรฟินที่ได้ ส่วนมากจะมีตั้งแต่ 1-10 ชั้นของแกรฟินซึ่งยังยากต่อการควบคุม

2.6 การประยุกต์ใช้แกรฟีน

เนื่องจากคุณสมบัติพิเศษทางด้านต่างๆของแกรฟันดังที่กล่าวข้างต้น ทำให้มีงานวิจัยที่นำ แกรฟันไป ประยุกต์ใช้ใน ทรานซิสเตอร์, อุปกรณ์ทางการแพทย์, ตัวนำไฟฟ้า, ตัวนำความร้อน, วัสดุผสมเพื่อเพิ่มคุณสมบัติ เชิงกล และเทคโนโลยีเซ็นเซอร์ [39-53] งานวิจัยนี้ผู้วิจัยให้ความสำคัญกับการนำแกรฟันมาประยุกต์ใช้ใน เทคโนโลยีเซนเซอร์ เนื่องจากการตรวจจับโมเลกุลของสารเคมี, สารพิษ, ก๊าซพิษ หรือ ไวรัส ที่พบได้ในโรงงาน อุตสาหกรรม, ห้องปฏิบัติการวิจัยและสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากขึ้นทุกวันเพื่อช่วย ป้องกันการสูญเสียเนื่องมาจากการสัมผัสหรือได้รับสิ่งเหล่านั้น โดยผู้วิจัยเน้นการสร้างเซ็นเซอร์ตรวจจับแบบ ปฏิกิริยาตอบสนอง (responsive sensor) ซึ่งเป็นหลักการเดียวกับแอคซูเอเตอร์ (actuator) ดังนั้นในรายงาน นี้จะเน้นทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับเซ็นเซ<mark>อร์ตรวจจับ</mark>แบบปฏิกิริยาตอบสนองและแอคซูเอเตอร์

ความสามารถในการตรวจจับสารเคมีของแกรฟีนนั้นเนื่องมาจากพื้นที่ผิวของแกรฟีนที่มีมากถึง 1,300 m²/g และสมบัติทางด้านไฟฟ้า นอกจากจะใช้แผ่นเดี่ยวของแกรฟีน (single graphene) ในการพัฒนาเป็น เซ็นเซอร์ที่พบเห็นได้ทั่วไปแล้ว ฟิล์มแกรฟีน (graphene film) ที่เกิดจากการรวมตัวของแผ่นแกรฟีนหลายๆ แผ่น (graphene assembly) [54-56] และวัสดุผสมของแกรฟีน (graphene-based composite material) [57-59] ยังสามารถนำมาประยุกต์เป็นเซ็นเซอร์ได้เช่นกัน ภายใต้เงื่อนไขที่เหมาะสมแกรฟีนสามารถถูกเจือด้วย โมเลกุลของสารที่ให้หรือรับอิเล็กตรอนที่ดูดซับ<mark>แก่</mark>คาร์บอนอะตอมของแผ่นแกรฟีน [39-53]

ปฏิกิริยาตอบสนอง (response) หรือการเคลื่อนไหวแบบแอคซูเอชัน (actuation) ของแผ่นฟิลม์แกรฟัน (graphene film) นั้นเนื่องจากกระบวนการหลายอย่างรวมกัน ได้แก่ กระบวนการทางไฟฟ้าเคมี (electrochemistry) ของสารเคมีที่ดูดซับบนแกรฟีน, การนำไฟฟ้าของแต่ละแกรฟีนในฟิล์มแกรฟีน และสมบัติ เชิงกลของแต่ละแกรฟีนในฟิล์มแกรฟีนในการตรวจจับไอระเหยของสารเคมี สิ่งสำคัญของงานวิจัยนี้คือสารเคมี ที่ดูดซับบนแต่ละแกรฟีนทั้งหมดในฟิล์มแกรฟีนที่ทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองในภาพรวม [60-63]

การใช้แกรฟีนเป็นวัสดุพื้นในการปลูกผลึกอนุภาคโลหะระดับนาโนลงไปแผ่นแกรฟีนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพของแผ่นแกรฟีนให้ดีขึ้น มีความว่องไว(active) ที่สูงขึ้น สามารถตรวจจับปริมาณไอสารเคมีได้ดี ยิ่งขึ้น ใช้เป็นตัวตรวจวัดปริมาณไอระเหยสารเคมีที่มาสัมผัสกับพื้นผิวบริเวณพื้นที่ว่องไวสูง จะมีการถ่ายเท อิเล็กตรอนระหว่างผิวสัมผัสของวัสดุที่ใช้เป็นพื้นที่ว่องไวกับไอระเหยเคมี ซึ่งจะทำให้สภาพต้านทานไฟฟ้าของ วัสดุที่ใช้เป็นพื้นว่องไวเปลี่ยนไป จากหลักการนี้เองทำทราบถึงปริมาณของไประเหยทางเคมีที่สัมพันธ์กับ ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ตรวจวัดได้ โดยพิจารณาจากกราฟ CV (cyclic voltagram) ของวัสดุนั้นๆที่ใช้เป็นพื้น ผิวสัมผัสกับไอเคมีได้



แกรฟีนออกไซด์ให้มีสมบัติทางไฟฟ้าเคมีดีขึ้น [40]



รูปที่ 2.8 ตัวอย่างไ<mark>ซคลิกโวลแทมเมตทรีที่สังเคราะห์ขึ้นตามล</mark>ำดับ (ก) การเรียงตัวของคาร์บอนแบบมี ้ล้ำดับชั้นและ (B) M<mark>nO₂/C-24</mark>0 ที่อัตรา<mark>กา</mark>รสแกนต่<mark>างๆตั้งแต่</mark> 2 ถึง 100 mVs⁻¹ ที่แรงดันตัดเป็น 1.0 และ 0.0 V เทียบขั้วไฟฟ้า S<mark>CE</mark> [41]





2.1 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเ<mark>ทศ</mark> (information) ที่เกี่ยวข้อง

No.	Year	Title/Journal	Materials used	Specific Capacitance	Highlight	Calculation of
	of			(F•g ⁻¹)		C _{sp}
	Public					
	ation					
1.	2016	-Straight forward	C <mark>o₃O₄@</mark> CoWO₄/rGO core-shell arrays	enhanced specific	Hierarchical	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$
		synthesis of	on Ni	capacitance of 386 F•g ⁻¹ at	core/shell was	
		hierarchical		0.5 A•g-1	used to prepare of	
		Co ₃ O ₄ @CoWO ₄ /rGO			Co_3O_4 $Oor Oor Oor Oor Oor Oor Oor Oor Oor Oor $	
		core-shell arrays on			rGO nanoneedles	
		Ni as hybrid			materials were	
		electrodes for	No way was a second		successfully grown	
		asymme <mark>tr</mark> ic			on a 3D Ni foam	
		supercap <mark>acitors</mark>			substrate via a	
		- Ceramics	2 22		simple	
		International			hydrothermal	
		(2016)42 p.10719-			approach	
		10725				
		12.97				
	6					
2.	2016	- Synthesis of	Cu ₂ ZnSnS ₄ (CZTS)/reduced graphene	The specific capacitance for	To obtain that the	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$
	1 SX	CZTS/RGO	oxide (RGO) composite	CZTS/RGO in 3 M KOH	high conductivity	
	0	composite material		aqueous electrolyte was as	and large surface	
	20				area of RGO	



	as supercapacitor electrode - Ceramics International (2016) 42, p.10452-10458.	high as 591 F·g ⁻¹ at a current density of 0.25 A·g ⁻¹	resulted in the lower charge transfer and ion diffusion resistance in CZTS/RGO composite, which synergistically enhanced the capacitive performance of composite material.	
3. 2016	- Synthesis of mesoporousMesoporous RGO@(Co,Mn)₃O4 nanocompositeRGO@(Co,Mn)₃O4 nanocomposite by microwave-assisted method for supercapacitor application - Electrochimica Acta (2016) 210, p.240-Mesoporous RGO@(Co,Mn)₃O4 nanocomposite	A high capacitance of 1004 F•g ⁻¹ at 3 mV•s ⁻¹ in a 6 M KOH electrolyte solution	 The one-pot synthesis using microwave irradiation. A well distributed mesoporous layer along with the reduction of graphene oxide. 	C _s = IΔt/mΔV



4.	2016	- NiO mesoporous nanowalls grown on RGO coated nickel foam as high performance electrodes for supercapacitors and biosensors - Electrochimica Acta (2016) 192,p.205-215.	NiO mesoporous nanowalls grown on RGO coated nickel foam	high specific capacitance of about 950 F·g ⁻¹ at a current density of 5 A·g ⁻¹ with excellent cycling stability.	A novel and simple procedure is developed to fabricate well aligned NiO mesoporous nanowalls on the porous RGO coated Ni foam substrate.	C _s = IΔt/mΔV
5.	2015	-Facile synthesis of Cu ₂ O/RGO/Ni(OH) ₂ nanocomposite and its double synergistic effect on supercapacitor performance -Electrochimica Acta (2015) 165,p.314-322.	Cu ₂ O/RGO/Ni(OH) ₂	923.1 F•g ⁻¹ at 7.0 A•g ⁻¹	 1.Cu₂O/RGO/Ni(OH) 2. nanocomposite can synthesize through a facial one-pot hydrothermal method. 2. Specific capacity for Cu₂O is compensated and improved so that 	C _s = I∆t/m∆V



					the CRNN nanocomposite shows superior supercapacitor performance: 3969.3 mF·cm ⁻² (923.1 F·g ⁻¹) at 30 mA·cm ⁻²	
					(7.0 A•g ⁻¹)	
6.	2015	-Solid-type supercapacitor of reduced graphene oxide-metal organic framework composite coated on carbon fiber paper -Electrochimica Acta (2015) 157, p.69-77.	reduced graphene oxide-metal organic framework composite	high specific capacitance of 385 F·g ⁻¹ at 1 F·g ⁻¹	 Using a solid method for synthesized an active material. To obtain a high specific capacitance of 385 F•g⁻¹ at 1A•g⁻¹ 	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$
7.	2015	- Asymmetric and symmetric supercapacitors based on	- <i>Cladophora algae</i> derived cellulose+pyrrole - activated carbon electrodes	high specific capacitance of 211 F·g ⁻¹	1. Using the <i>Cladophora sp.</i> algae cellulose (CAC) solution was	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$



		polypyrrole and activated carbon electrodes - Synthetic Metals, 203 (2015) p.192-199.			mixed with pyrrole conductive polymer. 2. To obtain a capacitance loss of 5% was seen after 14300 cycles	
8.	2015	- High-performance supercapacitors using graphene/polyaniline composites deposited on kitchen sponge - Nanotechnology 26 (2015), p.1-11.	The both graphene platelets (GnPs) and polyaniline (PANi) nanorods were deposited on commercial grade kitchen sponge	To exhibite a specific capacitance of 965.3 F·g ⁻¹ at a scan rate of 10 mV·s ⁻¹ in 1.0 M H ₂ SO ₄ solution	This simple method holds promise for high- performance yet low-cost electrodes for supercapacitors.	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$
9.	2014	-Direct synthesis of rGO/Cu ₂ O composite films on Cu foil for supercapacitors -Journal of Alloys and	Reduced graphene oxide/cuprous oxide(rGO/ Cu ₂ O)	To exhibite a specific capacitance 98.5 at 1 A·g ⁻¹	1.To improve capacitance performance is realized by the hydrothermal treatment of	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$

	-					1
		Compounds,(2014)58			graphene oxides	
		6 p745-753.			with Cu foils.	
					2. RGO/Cu ₂ O/Cu-	
					200 composites	
					exhibit the largest	
					specific	
					capacitance of	
					98.5 F•g ⁻¹ at	
					1 A•g ⁻¹	
			discussion of the second			
10.	2014	-Nanostructured	Nanostructured CuO/reduced	To obtain a high specific	1. To obtain a	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$
		CuO/reduced	graphene oxide composite	capacitance	nanostructured	
		graphen <mark>e</mark> oxide	Sector Sector	of 326 F·g ⁻¹ at a current	CuG hybrid	
		composit <mark>e for hybrid</mark>		density of 0.5 A·g ⁻¹	composite	
		supercapacitors	2 129		material has been	
		-The Royal <mark>Society</mark>			synthesized by a	
		of Chemistry,(2014)			simple and an	
		4, 234 <mark>85</mark>			inexpensive	
					hydrothermal	
	6	30			method	
					2. A high specific	
	A SX				capacitance	



					of 326 F•g ⁻¹ at a current density of 0.5 A•g ⁻¹ .	
11.	2014	-Facile synthesis of hierarchical CuO nanorods arrays on carbon nanofibers for high performance supercapacitors - Ceramics International 40(2014), p.15973- 15979.	CuO nanorods arrays on carbon	high capacitance of 398 F·g ⁻¹ at 1A·g ⁻¹	1.To synthesize one-dimensional hierarchical hybrid nanostructure composed of CuO nanorods grown on carbon nanofibers 2. To obtain a high electrochemical performance including high capacitance (398 $F \cdot g^{-1}$ at $1A \cdot g^{-1}$) high-rate capability and high-power density ($10kWkg^{-1}$)	C _s = IΔt/mΔV



12.	2014	Nanostructured CuO/reduced graphene oxide composite for hybrid supercapacitors - The Royal Society of Chemistry 4(2014) , p.23485-23491.	CuO/reduced graphene oxide (RGO) nanocomposite electrodes	high specific capacitance of 326 F·g ⁻¹ at a current density of 0.1 A·g ⁻¹	simple, low cost hydrothermal method	C _s = I∆t/m∆V
13.	2014	Facile synthesis of nickel network supported three dimensional graphene gel as a lightweight and binder-free electrode for high rate performance supercapacitor application - Nanoscale, 6(2014), p.2426-2433.	three-dimensional graphene gel on nickel foam	high rate capability of 152 F·g ⁻¹ at 0.36 A·g ⁻¹ and 107 F·g ⁻¹ at 90.9 F·g ⁻¹ , good cycle stability	To improve the rate capability performance, greatly reduce the mass of the electrode, and lower the fabrication cost of supercapacitors	C _s = I∆t/m∆V
14.	2014	Scalable synthesis of hierarchically structured carbon	hierarchically structured carbon nanotube - graphene fibres	A specific volumetric capacity of 305 F cm ⁻³ in H_2SO_4 (at	- large specific surface area	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$

		nanotube-graphene		73.5 mA·cm ⁻³ , in a three-	(396 m ² ·g ⁻¹) and	
		fibres for capacitive		electrode	high electrical	
		energy storage		cell) and 300 F cm ⁻³ in	conductivity (102	
		- Nature		PVA/H₃PO₄ (at 26.7 mA•cm ⁻³ ,	S•cm ⁻²)	
		nanotechnology, 9		in a two-electrode cell).	- flexible	
		(2014), p.555-562.			capacitive energy	
					storage	
15.	2013	-Hierarchical	hierarchical nanocomposite (PANI-	high capacitance of 590 F·g ⁻¹	To improve	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$
		Nanocomposites of	frGO) of polyaniline	at 0.1 A·g ⁻¹ , had no loss of	electrochemical	
		Polyaniline Nanowire	(PANI) nanowire arrays	apacitance after 200 cvcles at	performance	
		Arrays on Reduced	and a second	2 A•σ ⁻¹	suggests promising	
		Graphene Oxide		27.5 .	application of the	
		Sheets f <mark>or</mark>	Second Second		PANI-frGO	
		Supercap <mark>acitors</mark>	1.57		nanocomposites in	
		- Scientific reports	2 29		high-performance	
		(2013) 3, p.1 <mark>-9.</mark>			supercapacitors.	
16.	2013	-Fabrication of	anchored copper oxide nanoparticles	To obtain specific	1. Synthesis of	$C_s = 4(I\Delta t/m\Delta V)$
		anchored copper	on graphene oxide nanosheets	capacitance of 245 F·g ⁻¹ at	copper oxide	
		oxide n <mark>anoparticl</mark> es		current density of 0.1 $A \cdot g^{-1}$	nanoparticles were	
	6	on graphene oxide	and the second		anchored on	
		nanosheets via an			graphene oxide	
	CAX.	electrostatic			nanosheets	
4	20	coprecipitation and			through a simple	
		AINA				

		its application as supercapacitor - Electrochimica Acta 88 (2013) p.347-357.			electrostatic coprecipitation 2. This composite material showed enhanced specific capacitance of 245 F•g ⁻¹ more than those of pure CuO of 125 F•g ⁻¹ and GO of 120 F•g ⁻¹	
17.	2013	Copper nanocrystal modified activated carbon for supercapacitors with enhanced volumetric energy and power density - Journal of Power Sources 236 (2013) p.215-223.	Copper nanocrystals homogeneously dispersed in activated carbon (AC)	resulting in the highest specific and volumetric capacity at 79 F·g ⁻¹ and 62 F cm ⁻³	 Cu modified activated carbon for supercapacitor was synthesized by in situ solution- based absorption reduction method Copper nanocrystals in AC has little effect on the surface area and porosity of activated carbon. 	C _s = I∆t/m∆V



18.	2013	- One-step solution-	RGO-Cu ₂ O-TiO ₂ ternary nanocomposite	specific capacitance of 80 F·g	1. The novel RGO-	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$
		phase synthesis of a		¹ at a current density of 0.2	Cu ₂ O-TiO ₂ ternary	
		novel RGO-Cu ₂ O-TiO ₂		A·g ⁻¹	nanocomposite	
		ternary			using one-step	
		nanocomposite with			solution-phase	
		excellent cycling			method	
		stability for			2. This excellent	
		supercapacitors			cycling stability is	
		- Journal of Alloys			exactly a	
		and Compounds			requirement for	
		(2013) 581, p. 303-			supercapacitors.	
		307				
19.	2013	- High-Performance	1.graphene nanosheet (Negative	To exhibit a preferable	appropriate	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$
		Asymmetric	electrode)	specific capacitance of 107	porativo alactrada	
				specific capacitatice of 101	negative electrode	
		Supercapa <mark>citor</mark>	2. c <mark>arboxylated multiw</mark> alled carbon	$F \cdot g^{-1}$ at a current density of 1	with suitable	
		Supercapacitor Based on	2. c <mark>a</mark> rboxylated multiwalled carbon nanotube/polyaniline (sGNS/	$F \cdot g^{-1}$ at a current density of 1 $A \cdot g^{-1}$.	with suitable potential and	
		Supercapacitor Based on Nanoarchitectured	2. carboxylated multiwalled carbon nanotube/polyaniline (sGNS/ cMWCNT/PANI)	F·g ⁻¹ at a current density of 1 A·g ⁻¹ . The remarkable energy	with suitable potential and matchable	
		Supercapacitor Based on Nanoarchitectured Polyaniline/Graphen	2. carboxylated multiwalled carbon nanotube/polyaniline (sGNS/ cMWCNT/PANI) (Positive electrode)	F·g ⁻¹ at a current density of 1 A·g ⁻¹ . The remarkable energy density of 20.5 Wh·kg ⁻¹ (25	with suitable potential and matchable capacitance will	
		Supercapacitor Based on Nanoarchitectured Polyaniline/Graphen e/Carbon Nanotube	2. carboxylated multiwalled carbon nanotube/polyaniline (sGNS/ cMWCNT/PANI) (Positive electrode)	F·g ⁻¹ at a current density of 1 A·g ⁻¹ . The remarkable energy density of 20.5 Wh·kg ⁻¹ (25 kW·kg ⁻¹) and the stable cycling	with suitable potential and matchable capacitance will further improve	
		Supercapacitor Based on Nanoarchitectured Polyaniline/Graphen e/Carbon Nanotube and Activated	2. carboxylated multiwalled carbon nanotube/polyaniline (sGNS/ cMWCNT/PANI) (Positive electrode)	F·g ⁻¹ at a current density of 1 A·g ⁻¹ . The remarkable energy density of 20.5 Wh·kg ⁻¹ (25 kW·kg ⁻¹)and the stable cycling performance with 91%	with suitable potential and matchable capacitance will further improve the performance	
		Supercapacitor Based on Nanoarchitectured Polyaniline/Graphen e/Carbon Nanotube and Activated Graphene Electrodes	2. carboxylated multiwalled carbon nanotube/polyaniline (sGNS/ cMWCNT/PANI) (Positive electrode)	F·g ⁻¹ at a current density of 1 A·g ⁻¹ . The remarkable energy density of 20.5 Wh·kg ⁻¹ (25 kW·kg ⁻¹)and the stable cycling performance with 91%	with suitable potential and matchable capacitance will further improve the performance of as-assembled	
		Supercapacitor Based on Nanoarchitectured Polyaniline/Graphen e/Carbon Nanotube and Activated Graphene Electrodes - <i>Appl. Mater.</i>	2. carboxylated multiwalled carbon nanotube/polyaniline (sGNS/ cMWCNT/PANI) (Positive electrode)	F·g ⁻¹ at a current density of 1 A·g ⁻¹ . The remarkable energy density of 20.5 Wh·kg ⁻¹ (25 kW·kg ⁻¹)and the stable cycling performance with 91%	with suitable potential and matchable capacitance will further improve the performance of as-assembled asymmetric	
		Supercapacitor Based on Nanoarchitectured Polyaniline/Graphen e/Carbon Nanotube and Activated Graphene Electrodes - Appl. Mater. Interfaces, 2013, 5	2. carboxylated multiwalled carbon nanotube/polyaniline (sGNS/ cMWCNT/PANI) (Positive electrode)	F·g ⁻¹ at a current density of 1 A·g ⁻¹ . The remarkable energy density of 20.5 Wh·kg ⁻¹ (25 kW·kg ⁻¹)and the stable cycling performance with 91%	with suitable potential and matchable capacitance will further improve the performance of as-assembled asymmetric supercapacitor	

20.	2012	-Polyaniline grafted	Conducting polyaniline-grafted	Electrical conductivity as high	PANi can improve	$C_s = I\Delta t/m\Delta V$
		reduced graphene	reduced graphene oxide (PANi-g-rGO)	as 8.66 S•cm ⁻¹ and	specific capacitance	
		oxide for efficient	composite	capacitance of 250 F·g ⁻¹ with	of g-rGO composite	
		electrochemical	4000	good cycling stability	as a highest specific	
		supercapacitors			and volumetric	
		- American Chemical			capacity at 250 F·g ⁻¹	
		Society (2012) 6 p	4992		and high electrical	
		1715-1723			conductivity of 8.66	
		1110 1120.			S•cm ⁻¹	





3.1 วิธีการเตรียมสารตัวอย่าง

3.1.1 วิธีการสังเคราะห์แกรฟีนออ<mark>กไซด์</mark>

แกรไฟต์สามารถเปลี่ยนเป็นแกรไฟต์ออกไซด์ได้ด้วยการปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation reaction) โดยวิธี Hummer's method ซึ่งนำผงแกรไฟต์จำนวน 3 กรัมผสมระหว่างกรด ซัลฟิวริก (H₂SO₄) ปริมาตร 69 ml, โซเดียมไนโตรท (NaNO₃) จำนวน 3 กรัม และผงโปรแทส เซียมเปอร์แมงกาเนส (KMnO₄) จำนวน 9 กรัม ในภาชนะซึ่งมีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส แล้วคนส่วนผสมนาน 30 นาที (รักษาอุณหภูมิไม่ให้เกิน 35 องศาเซลเซียส)



รูปที่ 3.1 แสดงการผสมระหว่างกรดซัลฟิวริกเข้มข้นกับโซเดียมไนโตรท ผงแกรไฟต์และผงโปรแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส (ใน ice bath)

 2. จากนั้นนำสารผสมดังกล่าวมาจากนั้นเติมน้ำปลอดไอออน 138 ml (ค่อยๆเติมที่ละน้อย เนื่องปฏิกิริยาค่อนข้างจะคายความร้อนอย่างมาก) แล้วปรับอุณหภูมิให้ได้ 80 องศาเซลเซียส พร้อมคนส่วนผสมนาน 30 นาที ของผสมที่ได้จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาล จากนั้นนำของผสม ดังกล่าวมาแช่ในอ่างน้ำเย็นทิ้งไว้ 10 นาที นำไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H₂O₂) ความเข้มข้น 30
 % โดยปริมาตร จำนวน 3 ml เติมลงในของผสมนี้ จะเกิดการแยกตัวของชั้น แกรฟันออกไซด์ จะมีสีเหลืองอ่อน และชั้นของ MnO₂ ซึ่งเป็นตะกอนสีน้ำตาลตกตะกอนที่ก้นของบีกเกอร์ วางบีก เกอร์ไว้หนึ่งคืนเพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์



รักษาอุณหภูมิไม่เกิน 35 องศา เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที

รูปที่ 3.2 การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันระหว่างผงแกรไฟต์กับกรดซัลฟิวริก เข้มขั้นกับโซเดียมไนโตรทและผงโปรแทสเซียมเปอร์แมงกาเนส

3. ดูดสารละลายแกรฟีนออกไซด์(สารละลายสีเหลือง) ด้วยปีเปตแล้วกรองด้วยระบบ สุญญากาศ(vacuum filtration) ล้างหลายครั้งด้วยน้ำปลอดไอออน จนน้ำที่ใช้ล้างมีค่า pH ประมาณ 7 แล้วล้างด้วยเมทานอลและตามด้วยสารละลายอะซิโตน ขั้นตอนสุดท้ายอบแห้งใน ด้วยระบบสุญญากาศ(vacuum drying) นาน 3 ชั่วโมง

3.1.2 <mark>วิธีการสังเครา</mark>ะห์วัสดุรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์

4. นำผงแกรฟีนออกไซด์จำนวน 0.5 กรัม ละลายในน้ำปลอดไออนปริมาตร 250 ml แล้วเขย่า ด้วยเครื่องอุลตราโซนิค ความถี่ 40 kHz เป็นเวลา 20 นาที แล้วเติมสารละลายไฮดราซีนโม โนไฮเดรต (NH₂NH₂·H₂O) ด้วยอัตราส่วน GO : NH₂NH₂·H₂O = 3 : 1 %v/v โดยใช้วิธี รีฟลักซ์ (reflux method) ที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง





<mark>รูปที่ 3.3 แสดงการเตรียมรีดิวซ์แ</mark>กรฟีนออกไซด์ด้วยวิธีการรีฟลักซ์ เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

5. นำตัวอย่างที่เตรียมได้ในข้อ 4 มากรองด้วยกรองสุญญากาศ (vacuum filtration) โดยใช้ กระดาษกรองเบอร์ 40 ล้างด้วยน้ำปลอดไอออนหลายครั้งจนค่า pH ของน้ำที่ใช้ล้างตัวอย่างมี ค่าประมาณ 7 จากนั้นล้างตัวอย่างด้วยเมทานอลและอะซิโตนตามลำดับ

3.<mark>1.3</mark> วิธีการสังเคราะห์วัสดุผสมรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์/ซิงค์ออกไซด์อนุภาคระดับนาโนเมตร (reduced graphene oxide/zinc oxide nanoparticles: rGO/ZnO NPs)

 6. นำผงแกรฟีนออกไซด์ จำนวน 0.5 กรัม ละลายในน้ำปลอดไอออนปริมาตร 250 ml เติมผง ซิงค์คลอไรด์ต่อแกรฟีนออกไซด์ในอัตราส่วน 1 : 3 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร สารละลายโซเดียม ความเข้มข้น 1 M ปริมาตร 30 ml และสารละลายไฮดราซีนโมโนไฮเดรต 5 ml เขย่าด้วย เครื่องอัลตราโซนิค ความถี่ 40 kHz เป็นเวลา 20 นาที

7. <mark>นำของผสมในหัวข้อ 6 มาบรรจุในขวดแก้ว ขนาด 250 ml</mark> แล้วใส่ในเครื่องไมโคเวฟ ตั้ง กำลังไฟฟ้าที่ 420 วัตต์ ครั้ง 30 วินาที พักครั้งละ 10 วินาที จนครบ 5 นาที



้ รู**ปที่ 3.4** การเตรียมซิงค์ออกไซด์/รีดิวซ์แก</mark>รฟีนออกไซด์ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

8. นำตัวอย่า<mark>งที่เตรียม</mark>ได้ในข้อ 7 มากรองด้วยกรองสุญญากาศ (vacuum filtration) โดยใช้ กระดาษกรองเบอร์ 40 ล้างด้วยน้ำปลอดไออนหลายครั้งจนค่า pH ของน้ำที่ใช้ล้างตัวอย่างมี ค่าประมาณ 7 จากนั้นล้างตัวอย่างด้วยเมทานอลและอะซิโตนตามลำดับ



รูปที่ 3.5 แสดงการกรองสารตัวอย่างด้<mark>วยเครื่อ</mark>งกรองสุญญากาศ

3.1.4 วิธีการสังเคราะห์วัสดุผสมคอปเปอร์ออกไซด์/รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ (copper oxide nanoparticles/reduced graphene oxide: CuO/rGO NPs)

 นำผงแกรฟีนออกไซด์ จำนวน 0.5 กรัม ละลายในน้ำปลอดไอออนปริมาตร 250 ml เติมผง คอปเปอร์ซัลเฟตต่อแกรฟีนออกไซด์ในอัตราส่วน 1 : 2 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร สารละลาย โซเดียมความเข้มข้น 1 M ปริมาตร 30 ml และสารละลายไฮดราซีนโมโนไฮเดรต 5 ml เขย่า ด้วยเครื่องอัลตราโซนิค ความถี่ 40 kHz เป็นเวลา 20 นาที 2. นำของผสมในหัวข้อ 1 มาบรรจุในขวดแก้ว ขนาด 250 ml แล้วใส่ในเครื่องไมโคเวฟ ตั้ง กำลังไฟฟ้าที่ 420 วัตต์ ครั้ง 30 วินาที พักครั้งละ 10 วินาที จนครบ 5 นาที



<mark>รูปที่ 3.6 การเตรียมคอ</mark>ปเปอร์ออกไซด์<mark>/รีดิ</mark>วซ์แกรฟีนออกไซด์ด้วยคลื่นไมโครเวฟ

8. นำตัวอย่าง<mark>ที่เตรียมได้ในข้อ 2 ม</mark>ากรองด้วยกรอ</mark>งสุญญากาศ (vacuum filtration) โดยใช้ กระดาษกรองเบอร์ 40 ล้างด้วยน้ำปลอดไออนหลายครั้งจนค่า pH ของน้ำที่ใช้ล้างตัวอย่างมี ค่าประ<mark>มาณ 7 จากนั้น</mark>ล้า<mark>งตัวอย่างด้ว</mark>ยเมทานอลและอะซิโตนตามลำดับ



รูปที่ 3.7 แสดงการกร<mark>องสาร</mark>ตัวอย่<mark>างด้วยเค</mark>รื่องกรองสุญญากา<mark>ศ</mark>

9. ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของสารตัวอย่างแกรฟีนออกไซด์ รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ (GO) รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ (rGO) ซิงค์ออกไซด์ (ZnO) ซิงค์ออกไซด์/รีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ คอปเปอร์ ออกไซด์/รีดิวซ์แกรฟีนออก ด้วยเครื่องมือดังต่อไปนี้

9.1 เครื่องวิเคราะห์สารประกอบทางเคมี (X-ray diffractometer : XRD) ในช่วงสแกน 5[°]-80[°] (2theta) ความเร็วในการสแกน 0.2 ดีกรี/วินาที 9.2 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope : SEM)
9.3 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (Transmission electron microscope : TEM)
9.4 เครื่องดูดกลืนรังสีอินฟาเรด (Fourier transform infrared spectroscope : FT-IR)
9.5 เครื่องวิเคราะห์การสลายตัวเชิงความร้อน (Thermogravity analyzer : TGA) ในข่วง
อุณหภูมิ 50 °C -1000 °C อัตราการขึ้นของอุณหภูมิ 10 °C/min.
9.6 เครื่องวัดพื้นที่ผิวจำเพาะ (Brunauer, Emmett and Teller : BET)

3.1.5 การเตรียมฟิล์มบางชั้นแอคทีฟ (active film layer)

1. นำสารตัวอย่าง GO rGO ZnO/rGO และ CuO/rGO แล้วนำขั้วไฟฟ้าชนิดสามขั้ว โดยใช้ เกรซซีคาร์บอน (glassy carbon) เส้นผ่านศูนย์ 3 mm. เป็นขั้วไฟฟ้าทำงาน (working electrode) ลวดแพลตตินัมเป็นเคาเตอร์อิเล็กโทรด และใช้ขั้วไฟฟ้า Ag/AgCl เป็นขั้วไฟฟ้า อ้างอิง (reference electrode) ตามลำดับ ดังแสดงดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 แสดงรูปตัวอย่างขั้วไฟฟ้าที่ใช้ในการวิจัยนี้ a) ขั้วไฟฟ้าที่ใช้ทุดลอง b) ขั้วไฟฟ้า แกรซซีคาร์บอนที่เคลือบด้วยวัสดุว่องไว (active material)

2. กา<mark>รเตรียม</mark>ฟิล์มบนขั้วไฟฟ้า (แผ่นสแตนเลส)

- ตัดแผ่นสแตนเลสขนาด 2.5×2.5 ตารางเซนเมตร ล้างทำความสะอาดพื้นผิวชิ้นงาน ด้วยเมธานอลบริสุทธิ์และอะซิโตนแล้วอบที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 30 นาที
- นำสารประกอบในข้อ 6.13 และข้อ 6.14 มาบุคละเอียดด้วยอาเกตมอร์ตา(agate mortar) แล้วเตรียมสารละลายพอลิอะนิลีน (Polyaniline, PANI) ในสารละลาย DMF โดยใช้อัตราส่วน 1 mg PANI ต่อ 10 ml DMF แล้วให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส แล้วกวนตลอดเวลาจนกระทั้งเกิดเป็นสารละลายสีเขียว
- นำสารละลายในข้อ 2 ผสมกับสารประกอบ rGO/ZnO NPs และ rGO/CuO NPs
 โดยอัตราส่วนของสารประกอบต่อสารละลายพอลิอะนิลีนเท่ากับ 0.5 g : 3 ml มา

เคลือบลงบนแผ่นส<mark>แต</mark>นเลสในข้อ 1 ในเครื่อง doctor blade ให้มีความหนาของ ฟิล์ม **1** mm แล้วอ<mark>บตัวอ</mark>ย่างในบรรยากาศไนโตรเจนที่อุณหภูมิ 250 องศาเซลเซียส นาน 2 ชั่วโมง



รูปที่ 3.9 แสด<mark>งรูปตัวอย่</mark>างการเคลือบด้วยฟิล์ม a) ZnO/rGO NPs และ b) CuO/rGO แต่ละชิ้น

4. ประกบตัวอย่างในข้อ 3 แล้วกั้นด้วยแผ่นพอลิโพรพิลีน (polypropylene

membrane : PP membrane) ซึ่งทำหน้าที่เป็นเยื่อเลือกผ่านให้ไอออนของ KOH (ความ เข้มข้<mark>นที่ใช้ 2 M</mark>) สามารถเลือกเปลี่ยน<mark>ระหว่างข</mark>ั้วไฟฟ้าทั้งสองได้ จากนั้นต่อขั้วไฟฟ้า

การศึกษาพฤติกรรมทางไฟฟ้า (electrochemistry) ของสารตัวอย่างเมื่ออยู่สารละลาย อิเล็กโทรไลท์

 วัดทางไฟฟ้าเคมี ได้แก่ค่า CV (cyclic voltagramm) และค่าการอัดประจุและค่าการ คายประจุ (charge/discharge) เป็นต้น เป็นการวัดพฤติกรรมทางไฟฟ้าด้วยเทคนิค ไซคลิกโวลแทมเมตรี โดยขั้วไฟฟ้าในข้อ 3.1.3-3.1.4 ถึง โดยใช้ศักย์ไฟฟ้าในช่วง 0 ถึง 0.5 โวลต์ โดยใช้สารละลาย KOH ความเข้มข้น 2 M

 2. เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวเก็บประจุยิ่งยวดที่ใช้แกรฟีนออกไซด์ ซิงค์ออก ไซด์/รีดิวซ์แกรฟีนและคอปเปอร์(I)ออกไซด์/แกรฟีนออกไซด์ เพียงอย่างเดียวกับค่าไฟฟ้า เคมีกับข้อที่ 3.1.3-3.1.4 แล้ววิเคราะห์ผลที่ได้จากผลทางไฟฟ้าเคมีมาออกแบบเป็นตัวเก็บ ประจุไฟฟ้ายิ่งยวดต้นแบบแล้วนำข้อมูลทั้งหมดมาแปรผลแล้วหาเงื่อนไขที่เหมาะสม เป็น ข้อมูลในการประดิษฐ์เป็นตัวเก็บประจุยิ่งยวดต้นแบบ



รูปที่ 3.10 แสดงตัวอย่างตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดต้นแบบ

3.2 สถานที่ทำการทดลอง

 ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์วัสดุ สาขาวิชาศึกษาทั่วไป-วิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่ศาลายา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

บทที่ 4 ผลการศึกษ<mark>าแล</mark>ะวิเคราะห์ผลการทดลอง







4.2 การศึกษาองค์ประกอบของโลหะออกไซด์-แกรฟีนด้วยเทคนิคการสลายเชิงความร้อน



รูปที่ 4.2 แสดงองค์ประกอบของโลหะออกไซด์-แกรฟีนด้วยเทคนิคการสลายเชิงความร้อน

4.3 ผลการตรวจวัดคุณลักษณะเฉพาะ<mark>ของแ</mark>กรฟีนออกไซด์



้ **รูปที่ 4.3** a) รีดิว<mark>ซ์แ</mark>กรฟีนออกไซด์กำลังขยาย 300<mark>00 เท่า b) รี</mark>ดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กำลังขยาย 30<mark>000 เท่า</mark> c) กา<mark>รปลูกผลึก</mark>คอปเปอร์ออกไซด์บนแผ่นรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ d) การปลูกผลึกซิงค์อ อกไซด์บนแผ่นรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์



<mark>4.4 การศึกษาสารประกอบทางเคมีและความเป็นผลึกด้วยเทคนิค XRDของวัสดุคอมโพสิต GO</mark>

รูปที่ 4. แสดงความสัมพันธ์ระหว่างมุมเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์กับความเข้มรังสีเอกซ์เพื่อยืนยัน สารประกอบในสารตัวอย่าง



รูปที่ 4.5 แสดงก<mark>ราฟไซคลิก</mark>โวลท<mark>าแกรมของวัสดุคอมโพสิต GO,</mark> rGO, ZnO/rGO และ CuO/rGO



รูปที่ 4.6 แสดงความมีเสถียรภาพของกราฟไซคลิกโวทาแกรมในช่วงความต่างศักย์ของตัวเก็บประจุ ไฟฟ้ายิ่งยวด CuO/rGO และ ZnO/rGO ชนิดตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดแบบลูกผสม



รูปที่ 4.7 แสดงการชาร์<mark>จประจุแ</mark>ละการ<mark>คายป</mark>ระจุของตัวต้นแบบตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดCuO/rGO และ ZnO/rGO ชนิดตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดแบบลูกผสมซึ่งแปรค่าความหนาแน่นกระ ไฟฟ้า<mark>ที่ป้อนให้กับตัว</mark>เก็บประจุต้นแบบ



รูปที่ 4.8 แสดงความมีเสถียรภาพของวัสดุคอมโพสิต CuO/rGO และ ZnO/rGO ชนิดตัวเก็บประจุ ไฟฟ้ายิ่งยวดแบบลูกผสม

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าพื้นที่ผิวจำเพาะ ค่าความจุไฟฟ้าจำเพาะ ค่าความหนาพลังงาน และค่า กำลังไฟฟ้า

Sample	Specific surface area (m ² /g)	C _{sp} (F/g)	E(kWh/kg)	P (kW/kg)
Raw graphite annealed at 300 °C for 2 h	109.16	55.86±2.52	5.23	7.66
rGO	625.89	<mark>2</mark> 05.66±4.04	14.20	19.90
ZnO/rGO composite	94.25	314.06±4.00	14.58	21.51
CuO/rGO composite	645.33	180.22±3.21	12.26	17.58
ZnO/rGO : CuO/rGO	655.32	460 <mark>.26±</mark> 4.25	18.36	25.23



บทที่ 5 ก<mark>ารอธิ</mark>บายผลและข้อสรุป

5.1 การอธิบายผล

5.1.1 การศึกษาหมู่ฟังก์ชันของส<mark>ารเตรี</mark>ยมที่เตรียมได้

เทคนิค FTIR ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบการมีอยู่ของออกซิเจนที่มีฟังก์ชันและการเปลี่ยนแปลงหลังจาก การให้มีความชื้น ในรูปที่ 1 แสดงสเปกตรัม GO FTIR จุดยอดที่สังเกตได้ที่ 1717.5 cm⁻¹ และ 1586 cm⁻¹อาจเกิดจากกลุ่ม C = O และกลุ่มอะโรมาติก C = C กลุ่มไฮดรอกซิล (-OH) แสดงวงกว้างเป็น ศูนย์กลาง รอบ 3235.5 cm⁻¹ สเปกตรัม FTIR ของคอมโพสิต ZnO/rGO สังเกตได้ในรูปที่ 1 (เส้นสีม่วง) และยอดพีค C=O จะหายไป และ C-O ลดลงซึ่งบ่งชี้ว่าการกำจัดกลุ่มทำงานที่ประกอบด้วยออกซิเจน และการลดลงบางส่วนของ GO นำไปสู่การก่อตัวของกราฟีนออกไซด์ลดลงเป็น rGO ในคอมโพสิต ซึ่ง พิสูจน์แล้วว่า ชั้น rGO ตามลำดับ พบว่ามีหมู่ฟังก์ชันของสารตัวอย่างที่เตรียมได้ดังต่อไปนี้

ตารางที่ 5.1 แสดงห<mark>มู่ฟังก์ชันท</mark>ี่เตรียมได้

ลำดับที่	สารตัว <mark>อย่า</mark> ง	เลขคล <mark>ื่น</mark> (cm ⁻¹)	หมู่ฟังก์ชั่น
1.	GO	1230-1320, 15 <mark>00-16</mark> 00,	С-О-С, С=С, СООН
		<mark>1650-1750, 3530 และ 305</mark> 0-	С-ОН, С-ОН,
		3800	
2.	rGO	1430, 980	C-H, C=C
3.	ZnO/rGO	1600, 980	C=C aromatic, C=C
500			bending
4.	CuO/rGO	3400, 32 <mark>00</mark> , 1600, 1250, 980	<mark>O-H, C-H บน</mark> CC, C-O,
	6		C=C bending

5.1.<mark>2 การศึกษ</mark>าการสลา<mark>ยตัวเชิงความร้อนด้วยเทคนิค TGA</mark>

จากรูปที่ 4.2 เป็นการศึกษาการสลายเชิงความร้อนของสารตัวอย่าง GO rGO ZnO/rGO CuO/rGO เพื่อหาปริมาณของ ZnO ที่จับอยู่บนพื้นผิวของวัสดุรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์กรณี GO ที่อุณหภูมิ 180 °C มีการสลายตัวของออกซิเจนที่อยู่สารตัวอย่างสลายตัวไป 15% เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 200 °C มี การระเหยของน้ำและความชื้นและสลายตัวขึ้นอีก 10% เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 600 °C คาร์บอนที่อยู่ใน สารตัวอย่างเกิดความไม่เสถียรจะเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในสารตัวอย่าง เกิดการสลายตัวเป็นCO หรือ CO₂ สลายตัวเชิงความร้อนเป็น 77%ในส่วนของ rGO เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 200 °C มีการสลายตัวของ ออกซิเจนที่อยู่สารตัวอย่างสลายตัวไป 12% เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 640 °C คาร์บอนที่อยู่ในสารตัวอย่าง เกิดความไม่เสถียรจะเกิดปฏิกิริยากับออกซิเจนในสารเจือปนในสารตัวอย่าง เกิดการสลายตัวเป็น CO

42

หรือ CO₂ สลายตัวเชิงความร้อนเป็น 40<mark>% เ</mark>มื่อพิจารณาตัวอย่างที่เป็น CuO อนุภาคระดับนาโนเมตร มี การสลายตัวเชิงความร้อนในระดับต่ำ ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิ 190-250°C และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเป็น 250 °C มีการสลายตัวของหมู่ไฮดรอกซิล (OH) ที่อยู่ในสารตัวอย่าง [77]ส่วนตัวอย่าง

5.1.3 ผลการตรวจวัดคุณลักษณะ<mark>เฉพ</mark>าะด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

จากรูปที่ 4.3 a) แสดงสัณฐานของแผ่นออกไซด์ซึ่งด้วยถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน แบบส่องกราดมีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายใบผักคะน้ำ ส่วนรูป b) แสดงรูปสัณฐานของแผ่นรีดิวซ์แกรฟีน ออกไซด์บนแผ่นซิลิกอน รูป c) แสดงการปลูกผลึกของอนุภาคคอปเปอร์ออกไซด์บนพื้นผิวของแผ่นรีดิวซ์ แกรฟีนออกไซด์มีขนาดอนุภาคของคอปเปอร์ออกไซด์จับอยู่บนพื้นผิวของแผ่นรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์ การ ที่อนุภาคคอปเปอร์ออกไซด์จับที่พื้นผิวของแผ่นรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จะช่วยในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนให้ แผ่นรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์สามารถถ่ายโอนประจุในปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ดีขึ้น มีขนาดอนุภาคของคอปเปอร์ ออกไซด์เท่ากับ 75.21± 6.36 นาโนเมตร รูป d) แสดงการปลูกผลึกของอนุภาคซิงค์ออกไซด์บนพื้นผิว ของ แผ่นรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์มีขนาดอนุภาคของซิงค์ออกไซด์จับอยู่บนพื้นผิวของแผ่นรีดิวซ์แกรฟีน ออกไซด์ ในทำนองเดียวกันการที่อนุภาคซิงค์ออกไซด์จับที่พื้นผิวของแผ่นรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์จะช่วยใน การถ่ายโอนอิเล็กตรอนให้แผ่นรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์สามารถถ่ายโอนประจุในปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ดีขึ้น ใน การปลูกผลึกครั้งนี้มีขนาดอนุภาคของซิงค์ออกไซด์สามารถถ่ายโอนประจุในปฏิกิริยารีดอกซ์ได้ดีขึ้น ใน

5.1.4 <mark>การศึกษาสา</mark>รป<mark>ระกอบทางเ</mark>คมีและ<mark>ความเป็นผลึก</mark>ด้วยเทคนิค XRD

รูปแบบ XRD ของแกราฟีท์ออกซ์, แกราฟีนออกไซด์และคอมโพสิต (G-ZnO)แสดงในรูปที่ 4.4 จุดสูงสุดที่สำคัญของรีดิวซ์แกรฟีนออกไซด์อยู่ที่ 2**0** = 25.5 ° การคำนวณระยะห่างระหว่างระนาบผลึก ของแกรฟีนโดยใช้สมการของ Scherrer's equation

$$\tau = \frac{\kappa \lambda}{\beta \cos \theta} \tag{1}$$

เมื่อ κ คือ ระยะเฉลี่ยของบริเวณระนาบผลึก κ คือ ค่าสัมประสิทธิรูปร่างของผลึก (sharp factor) λ คือ ค่าความยาวคลืนของรังสีเอกซ์ที่ใช้วิเคราะห์ตัวอย่าง β คือ ความกว้างที่ความสูงเป็นครึ่งหนึ่งของความ สูงสุดสุด(full width haft maximium : FWHW) θ คือ มุมของแบรก (Bragg's angle) โดยมีระยะห่าง ระหว่างระนาบผลึกเท่ากับ 1.43 Å หลังจากออกซิเดชั่นค่าสูงสุดจะถูกสังเกตที่2θ = 10° ใน GO เพื่อ แสดงการออกซิเดชั่นอย่างสมบูรณ์แบบ ระยะทางระหว่างชั้นที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นผลมาจากกลุ่มหมู่ฟังก์ชัน ออกซิเจนในระหว่างกระบวนการออกซิเดชันมีจุดสูงสุดห้าจุดในวัสดุคอมโพสิต G-ZnO ที่ค่า2θ= 31.8 °, 34.4 °, 36.2 °, 47.5 °และ 56.5° ซึ่งสอดคล้องกับ (100), (002), (101), (102) และ (110) ของผลึก ระนาบของ ZnO ตามลำดับ ระนาบผลึกเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในโครงสร้างของ wurtzite ของอนุภาค ZnO ที่ สอดคล้องกับ JCPDS No.36-1451 ขนาดผลึก ZnO เฉลี่ยที่คำนวณจากสูตร Schererคือ 2.1 นาโนเมตร นอกเหนือจากจุดสูงสุด rGO สามารถเห็นได้ที่ 2θ = 24.5 ° มันแสดงให้เห็นว่าระยะทางระหว่างชั้น ระหว่างแผ่นกราฟีนคือ 1.6 nm ซึ่งมีขนา<mark>ดใ</mark>หญ่กว่าระยะทางชั้นของแกรไฟท์ธรรมชาติเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่า กลุ่มของฟังก์ชันการทำงานของออกซิเจนอาจมีอยู่ในแผ่นกราฟีนเส้นสีน้ำตาลแสดงการเลี้ยวเบนของฟิล์ม บางเอกซ์เรย์ (LXRD) รูปแบบของผลึกของ CuO แสดงตำแหน่งและความเข้มของสัมพัทธ์ของยอดเขาที่ เลี้ยวเบนเข้ากันได้ดีด้วยรูปแบบมาตรฐานของ CuO มีเก้าจุดยอดพีคที่ตำแหน่ง 2**0** ตรงกับการปลูกผลึก ของ CuO เป็นแบบ monoclinic (JCPDS 05-0661) ซึ่งบ่งชี้ว่าผลึก Cu₂O สามารถเปลี่ยนโครงสร้างเป็น CuO คือ สังเกตโดยปกติแล้วในบรรดายอดเขาเหล่านี้ มียอดพีคสองตัวที่สูงสุดอยู่ที่ค่า2**0** ที่ตำแหน่ง 35.51 และ 38.61 ที่สอดคล้องกับ (1–1 1) และ (111) ซึ่งสอดคล้องกับคุณลักษณะเฉพาะของผลึก CuO แบบ monoclinic มาตรฐาน [22]

5.1.5 การศึกษาสมบัติ<mark>ทางไฟฟ้าเคมีของเ</mark>ก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด

จากรูปที่ 4.5 เป็นการศึกษาเปรียบเทียบสวัสดุคอมโพสิตได้แก่ GO rGO ZnO/rGO และ CuO/rGO พบว่า ZnO/r<mark>GO มีประสิทธิภาพสูงที่สุด รอง</mark>ลงมาคือ CuO/rGO rGO และ GO ตามลำดับ จึงเลือกใช้วัสดุคอมโ<mark>พสิตสองชนิด คือ ZnO/rGO และ CuO/rGO</mark> เป็นวัสดุที่ใช้เคลือบลงบนแผ่นโลหะ

จากรูปที่ 4.6 แสดงกราฟโวลตาแกรมของวัสดุคอมโพสิต ZnO/rGO และ CuO/rGO ซึ่งทำการ แปรค่าการประจุไฟฟ้าในช่วง 0 ถึง 0.5 โวลต์ ในการทดลองนี้ใช้จำนวนรอบของการประจุไฟฟ้า 20 รอบ พบว่าวัสดุคอมโพสิตดังกล่าว มีเสถียรภาพที่ต่อประจุไฟฟ้าสูง ซึ่งคุณสมบัติเด่นของแกรฟันที่ปลูกผลึกด้วย โลหะออกไซด์ที่มีอนุภาคระดับนาโนเมตร

จากรูปที่ 4.7 แสดงการช<mark>า</mark>ร์จประจุและการคายประจุของตัวต้นแบบตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวด CuO/rGO และ ZnO/rGO ชนิดตัวเก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดแบบลูกผสมซึ่งแปรค่าความหนาแน่นกระไฟฟ้า ที่ป้อนให้กับตัวเก็บประจุต้นแบบ เมื่อป้อนกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้นจะทำให้การชาร์จประจุได้เร็วขึ้น ช่วง<mark>เวล</mark>าของการเก็บประจุจะสั้นลง

จากรูปที่ 4.8 แสดงความมีเสถียรภาพของวัสดุคอมโพสิต CuO/rGO และ ZnO/rGO ชนิดตัว เก็บประจุไฟฟ้ายิ่งยวดแบบลูกผสมจากการทดลองพบว่าความจุไฟฟ้าของตัวต้นแบบมีค่าเท่ากับ 460.26±4.25 F/g และจากกราฟของความจุไฟฟ้าจำเพาะกับค่าเวลาชาร์จ-คายประจุไฟฟ้าพบว่ามี ความสถียรภา<mark>พสูง</mark>

5.<mark>1.6 การ</mark>ศึกษา<mark>พื้นที่ผิวจำเพาะของสารตัวอย่างที่สัมพันธ์กับค</mark>วามจุไฟฟ้ายิ่งยวดของวัสดุ

จากตารางที่ 1. เป็นการศึกษาพื้นที่ผิวจำเพาะของสารตัวอย่างเป็นข้อมูลที่เติมเต็มงานวิจัยให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะพื้นที่ผิวของวัสดุที่มีค่าสูง จะบ่งบอกถึงพื้นที่ที่สามารถให้ประจุอิสระได้มากขึ้นหรือ สามารถกักเก็บประจุอิสระไว้ในสารตัวอย่างได้สูงขึ้น จากการทดลองพบว่า rGO มีพื้นผิวเจาะสูงสุด เนื่องจากการแผ่น แกรฟืนที่นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณพื้นที่ผิวจำเพาะเชิงทฤษฎีจะมีค่าเท่ากับ 2600 m²/g แต่ rGO เป็นแผ่นแกรฟืนที่นำเอาผงแกรไฟต์มาทำปฏิกิริยาเคมีเพื่อออกซิไดส์ให้ชั้นระหว่าง แกรไฟต์ขยับออก(แต่ละชั้นของแกรไฟต์ห่างกัน 0.34 nm) เป็นสองเท่าของระยะห่างแกรไฟต์ปกติ และ เมื่อได้รับการสั่นด้วยคลื่น อัลตราโซนิค(ultrasonic wave) ชั้นแกรไฟต์เหล่านี้จะหลุดออกมาแผ่นๆ (exfoliate) ในขั้นสุดชั้น แกรฟืนออกไซด์จะถูกรีดิวซ์เพื่อกำจัดหมู่โฮดรอกซิล (OH) และหมู่คาร์บอกซิลิก (-(C=O)-OH) บางส่วนออกไป ทำให้พื้นที่ผิวของ rGO มีค่าสูงที่สุดเท่ากับ 625.89 m²/g แต่เมื่อปลูกผลึก ZnO อนุภาคระดับนาโนเมตรเข้าไปบนพื้นผิวของ rGO อนุภาค ZnO จะเข้าไปอุดช่องว่างของ rGO ทำ ให้พื้นที่ผิวจำเพาะลดลงเท่ากับ 94.25 m²/g แต่อย่างไรก็ตาม แทนสมบัติทางไฟฟ้าเคมีจะลดต่ำแต่กลับ เพิ่มความแน่นกระแสไฟฟ้าเคมีให้สูงขึ้น เนื่องจากอนุภาค ZnO จะให้ประจุไฟฟ้าอิสระ(อิเล็กตรอน) ในทางตรงกันข้ามการปลูกผลึก CuO ขนาดอนุภาค 75.21± 6.36 นาโนเมตร จะเกาะอยู่ที่ผิวของแผ่นแก รฟื้นหรือเข้าแทรกระว่างแผ่นแกรฟืนออกไซด์ทำให้พื้นที่ผิวจำเพาะมีค่าสูงขึ้น (645.33 m²/g) ให้ค่าความ จุไฟฟ้าเท่ากับ 180.22±3.21 F/g (ค่าที่ได้คำนวณได้จากสูตรในตารางที่ 2.7) แต่เมื่อนำสารขั้วไฟฟ้า ZnO/rGO และ CuO/rGO จะเกิดการเสริมกันทำให้สมบัติทางไฟฟ้าเคมีดีเด่นยิ่งขึ้น ให้ค่าความจุไฟฟ้า จำเพาะเท่ากับ 460.26±4.25 F/g ค่าความหนาพลังงานเท่ากับ 18.36 kWh/kg และค่ากำลังไฟฟ้า 25.23 kW/kg นับการผสมผสานระหว่างขั้วไฟฟ้าที่มี rGO เป็นวัสดุแล้วปลูกผลึกโลหะออกไซด์อนุภาค ระดับนาโนเมตร ZnO/rGO และ CuO/rGO จะก็วงท้าให้สมบัติทางไฟฟ้าเคมีของตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมีดี ยิ่งขึ้น

5.2 ข้อแสนอแนะ

- หากได้รับการสนับสนุนทางงบประมาณสามารถนำเอาวัสดุนี้มาต่อยอดเป็นตัวประจุไฟฟ้า ยิ่งยวดประยุกต์ทางด้านแบตเตอรีได้ในอนาคต
- ข้อเพิ่งระวังในการเตรียมผลึกโลหะออกไซด์อนุภาคระดับนาโนเมตร ZnO/rGO และ CuO/rGO ไม่ควรใช้กำลังไฟฟ้าสูงมากและยาวนานเกินอาจทำให้ภาชนะที่ใส่สารตัวอย่าง ระเบิดได้ ควรพักให้ปฏิกิริยาเย็นตัวสักระยะ แล้วค่อยเริ่มปฏิกิริยาขึ้นมาใหม่



บรรณานุกรม

1. J.E. Troyan, Properties, Production, and Uses of Hydrazine.,Eng. Chem. Res. 1953, 45, 2608–2612.

2. Y.Wang, Y.Wan, D.Zhang, Reduced graphene sheets modified glassy carbon electrode for electrocatalytic oxidation of hydrazine in alkaline media, Electrochem. Commun. 2010, 12, 187-190.

3. E.H. Vernot, J.D. Mac Ewen, R. H. Bruner, C. C. Haun, E. R. Kinkead, D. E. Prentice, A. Hall, R. E. Schmidt, R. L. Eason, G. B. Hubbard, J. T. Young, Fundam. Appl. Toxicol. 1985, 5, 1050-1064.

4. World Health Organization, Environmental Health Criteria 68 : Hydrazine, Geneva, Switzerland, 1987, 1-89.

5. P. V. K. Rao, G. G. Rao, Talanta, Hydrazine sulphate as reagent for titrimetric determination of vanadium(V) and chromium(VI) 1973, 20, 907-910.

6. F. Dias, A. S. Olojola, B. Jaselskis, Spectrophotometric determination of micro amount of hydrazine and hydroxylamine alone and in the presence of each other, Talanta, 1979, 26, 47-49.

7. C.M. Morenoa, T. Stadler, A. A. Silva, L. C. A. Barbosa, M. E. L. R. Queiroz, Farication of Silver Hexacyanoferrate and Functionlized MWCNT with Poly(3,4ethylenedioxythiophene) Hybrid Film Modified Electrode for Selectively Determination of Ascorbic Acid And Hydrazine, Talanta, 2012, 89, 369-376.

8. M. Sun, L. Bai, D. Q. Liu, A generic approach for the determination of trace hydrazine in drug substances using *in situ* derivatization-headspace GC–MS*J. Pharm. Biomed. Anal*. 2009, 49, 529-533.

9. S. K. Kim, Y. N. Jeong, M. S. Ahmed, J. M. You, H. C. Choi, S. Jeon, Electrocatalytic determination of hydrazine by a glassy carbon electrode modified with PEDOP/MWCNTs-Pd nanoparticles. *Sens. Actuators B* 2011, 153, 246-251.

10. C. Wang, L. Zhang, Z. Guo, J. Xu, H. Wang, K. Zhai, X. Zhuo, Graphene Oxide Dispersed Carbon Nanotube and Iron Phthalocyanine Composite Modified Electrode for the Electrocatalytic Determination of Hydrazine Microchim. Acta, 2010, 169, 1-6.

11. V. Singh, D. Joung, L. Zhai, S. Das, S. I. Khondaker, S. Seal, Prog. Graphene based materials: Past, present and future, *Mater. Sci.* 2011, 56, 1178-1271.

12. D. R. Dreyer, S. Park, C. W. Bielawski, R. S. Ruoff, The chemistry of graphene oxide, *Chem. Soc. Rev.* 2010, 39, 228-240.

13. C. Xu, X. Wang, J. Zhu, Graphene - Metal particle nanocomposites J. Phys. Chem. C 2008, 112, 19841-19845.

14. Y. He, J. Zheng, S. Dong, Ultrasonic-electrodeposition of hierarchical flower-like cobalt on petalage-like graphene hybrid microstructures for hydrazine sensing, *Analyst* 2012, 137, 4841-4848.

15. P. V. Dudin, P. R. Unwin, J. V.Macpherson, Electro-oxidation of hydrazine at gold nanoparticle functionalised single walled carbon nanotube network ultramicroelectrodes, Phys.Chem.Chem.Phys. 2011,13, 17146-17152.

16. Y. Wang, Y. Wan, D. Zhang, Reduced graphene sheets modified glassy carbon electrode for electrocatalytic oxidation of hydrazine in alkaline media, Electrochem. Commun. 2010, 12, 187-190.

17. G. Hua, Z. Zhou, Y. Guo, H. Hou, S. Shao, Electrochemical Determination of Ascorbic Acid Using Poly(Xanthurenic Acid) and Multi-Walled Carbon Nanotubes, Electrochem .Commun. 2010,12, 422-426.

18. G. Gao, D. Guo, C. Wang, H. Li, Electrocrystallized Ag nanoparticle on functional multi-walled carbon nanotube surfaces for hydrazine oxidation *Electrochem. Commun.* 2007, 9, 1582–1586.

19. S. Chakraborty, C. R. Raj, Carbon nanotube supported platinum nanoparticles for the voltammetric sensing of hydrazine, Sens. Actuators *B* 2010,147, 222–227.

20. A.K. Geim, K.S. Novoselov, The rise of graphene, Nat. Mater., 2007, 6, 183-191

21. R. Mas-Ballest, C. Gomez-Navarro, J. Gomez-Herrero, F. Zamora, 2D materials: to graphene and beyond, *Nanoscale*, 2011, 3, 20-30.

22. L. Gong, I.A. Kinloch, R.J. Young, I. Riaz, R. Jalil, K.S. Novoselov, Interfacial stress transfer in a graphene monolayer nanocomposite, Adv. Mater., 2010, 22, 2694-2697.

23. C. Lee, X. Wei, J. Kysar, J. Hone, Measurement of the Elastic Properties and Intrinsic Strength of Monolayer Graphene, Science, 2008, 321, 385-388.

24. N. Ferralis, Probing mechanical properties of graphene with Raman spectroscopy, J. Mater. Sci., 2010, 45, 5135-5149.

25. A. K. Geim, Graphene: Status and Prospects, Science, 2009, 324, 1530-1534.

26. S. Stankovich, R. Piner, S.T. Nguyen, R.S. Ruoff, Synthesis and exfoliation of isocyanate-treated graphene oxide nanoplatelets, *Carbon*, 2006, 44, 3342-3347.

27. N. Liu, F. Luo, H. Wu, Y. Liu, C. Zhang, J. Chen, One-step ionic-liquid-assisted electrochemical synthesis of ionic-liquid-functionalized graphene sheets, directly from graphite, Adv. Funct. Mater., 2008, 18, 1518-1525.

28. S. Stankovich, D.A. Dikin, R. Piner, K.M. Kohlhaas, A. Kleinhammes, Y. Jia, Y. Wu, S.T. Nguyen, R.S. Ruoff, Synthesis of graphene-based nanosheets via chemical reduction of exfoliated graphite oxide,*Carbon*, 2007, 45, 155-1565.



29. G. Wang, J. Yang, J. Park, B. Wang, H. Liu, J. Yao, Facile synthesis and characterization of graphene nanosheets, J. Phys. Chem. C, 2008, 112, 8192-8195.

30. M.J. McAllister, J.L. Li, D.H. Adamson, H.C. Schniepp, A.A. Abdala, J. Liu, M. Herrera-Alonso, D.L. Milius, R. Car, R.K. Prud'homme, I.A. Aksay, Single sheet functionalized graphene by oxidation and thermal expansion of graphite, Chem. Mater., 2007, 19, 4396-4404.

31. S. Park, J. An, I. Jung, R. D. Piner, S. J. An, X. Li, A. Velamakanni, R. S. Ruoff, Colloidal suspensions of highly reduced graphene oxide in a wide variety of organic solvents, Nano Lett., 2009, 9, 1593-1597.

32. V. Chandra, J. Park, Y. Chun, J. W. Lee, I. Hwang, K. S. Kim, Water-dispersible magnetite-reduced draphene oxide composites for arsenic removal, *ACS Nano*, 2010, 4, 3979-3986.

33. S. Niyogi, E. Bekyarova, M.E. Itkis, M.A. Hamon, R.C. Haddon, R. C., Solution properties of graphite and graphene, *J. Am. Chem. Soc*., 2006, 128, 7720-7721.

34. S. Stankovich, R. Piner, X. Chen, N. Wu, S.T. Nguyen, R.S. Ruoff, Stable aqueous dispersions of graphitic nanoplatelets via the reduction of exfoliated graphite oxide in the presence of poly(sodium 4-styrenesulfonate), J. Mater. Chem., 2006, 16, 155-158.

35. J.I. Paredes, S. Villar-Rodil, A. Martinez-Alonso, J.M.D. Tascon, Graphene oxide dispersions in organic solvents, Langmuir, 2008, 24, 10560-10564

36. S. Park, J. An, R.D. Piner, I. Jung, D. Yang, A. Velamakanni, S.T. Nguyen, R.S. Ruoff, Aqueous suspension and characterization of chemically modified graphene sheets, Chem. Mater., 2008, 20, 6592-6594.

37. D. Li, M.B. Muller, S. Gilje, R.B. Kaner, G.G. Wallace, Processable aqueous dispersions of graphene nanosheets, *Nat.* Nanotechnol., 2008, 3, 101-105.

38. Y. Hernandez, V. Nicolosi, M. Lotya, F.M. Blighe, Z. Sun, S. De, I.T. McGovern, B. Holland, M. Byrne, J.J. Boland, P. Niraj, G. Duesberg, S. Krishnamurthy, R. Goodhue, J. Hutchison, V. Scardaci, A.C. Ferrari, J.N. Coleman, High-yield production of graphene by liquid-phase exfoliation of graphite, *Nat. Nanotechnol.*, 2008, 3, 563-568.

39. K.S. Novoselov, A. K. Geim, S.V. Morozov, D. Jiang, Y. Zhang, S.V. Dubonos, I.V. Grigorieva, A.A. Firsov, Electric field effect in atomically thin carbon films, Science, 2004, 306, 666-669.

40. H.C. Schniepp, J. -L. McAllister, H. Sai, M. Herrera-Alonso, D.H. Adamson, R.K. Prud'homme, R. Car, D.A. Saville, I.A. Aksay, Functionalized single graphene sheets derived from splitting graphite oxide, *J. Phys. Chem. B*, 2006, 110, 8535-8539.

41. J.E. Jang, S. N. Cha, Y.J. Choi, D.J. Kang, T.P. Butler, D.G. Hasko, J.E. Jung, J.M. Kim, G.A.J. Amaratunga, Nanoscale memory cell based on a nanoelectromechanical switched capacitor, *Nat. Nanotechnol.*, 2007, 3, 26-30.

42. K. S. Kim, Y. Zhao, H. Jang, S.Y. Lee, J.M. Kim, K.S. Kim, J.H. Ahn, P. Kim, J.Y. Choi, B.H. Hong, Large-scale pattern growth of graphene films for stretchable transparent electrodes, Nature, 2009, 457, 706-710.

43. J. Zhao, A. Buldum, J. Han, J.P. Lu, Gas molecule adsorption in carbon nanotubes and nanotube bundles. Nanotechnology, 2002, 13, 195-200.

44. J. Kong, N.R. Franklin, C. Zhou, M.G. Chapline, S. Peng, K. Cho, H. Dai, Nanotube nolecular wires as chemical sensors. Science, 2000, 287, 622-625.

45. J. Suehiro, S. Hidaka, S. Yamane, K. Imasaka, Fabrication of interfaces between carbon nanotubes and catalytic palladium using dielectrophoresis and its application to hydrogen gas sensor. Sensors and Actuators *B, 2007,* 127, 505-511.

46. I. Sayago, E. Te<mark>rrado, E. Lafuente, M.C. Horrillo, W.K</mark>. Maser, A.M. Benito, R. Navarro,

E.P. Urriolabeitia, M.T. Martinez, J. Gutierrez, Hydrogen sensors based on carbon nanotubes thin films. Synthetic Metals, *2005*, 148, 15-19.

47. R.K. Roy, M.P. Chowdhury, A.K. Pal, Room temperature sensor based on carbon nanotubes and nanofibres for methane detection. Vacuum, 2005, 77, 223-229

48. P.G. Collins, K. Bradley, M. Ishigami, A. Zettl, Extreme oxygen sensitivity of electronic properties of carbon nanotubes. Science, 2002, 287, 1801-1804.

49. L. Valentini, C. Cantalini, I. Armentano, J. Kenny, M. Lozzi, L.S. Santucci, Highly sensitive and selective sensors based on carbon nanotubes thin films for molecular detection. Diamond and Related Materials, 2004, 13, 1301-1305

50. L. Grigorian, K.A. Williams, S. Fang, G.U. Sumanasekera, A.L. Loper, E.C. Dickey, S.J. Pennycook, P.C. Eklund, Reversible intercalation of charged iodine chains into carbon nanotube ropes. Phys. Rev. Lett., 1998, 80, 5560–5563

51. R.S. Lee, H.J. Kim, J.E. Fischer, A. Thess, R.E. Smalley, Conductivity enhancement in single-walled carbon nanotube bundles doped with K and Br. Nature, 1997, 388, 255-257 52. A.M. Rao, S. Bandow, A. Thess, R.E. Smalley, Evidence for charge transfer in doped carbon nanotube bundles from Raman scattering. Nature, 1997, 388, 257-259

53. J. Fraysse, A.I. Minett, O. Jaschinski, G.S. Duesberg, S. Roth, Carbon nanotubes acting like actuators. Carbon, 2002, 40, 1735-1739.

54. Y. Xu, H. Bai, G. Lu, C. Li, G. Shi, Flexible Graphene films via the filtration of watersoluble noncovalent functionalized graphene sheets, J. Am. Chem. Soc., 2008, 130, 5856–5857 55. W. Bao, F. Miao, Z. Chen, H. Zhang, W. Jang, C. Dames, C.N. Lau, Controlled ripple texturing of suspended graphene and ultrathin graphite membranes, Nat. Nanotechnol., 2009, 4, 562-566.

56. Y. Lee, S. Bae, H. Jang, S. Jang, S.E. Zhu, S.H. Sim, Y.I. Song, B.H. Hong, J. H. Ahn, Wafer-Scale Synthesis and Transfer of Graphene Films, Nano Lett., 2010, 10, 490-493.

57. R. Muszynski, B. Seger, P.V. Kamat, Decorating graphene sheets with gold ganoparticles, J. Phys. Chem. C, 2008, 112, 5263-5266.

58. T. Ramanathan, A.A. Abdala, S. Stankovich, D.A. Dikin, M. Herrera-Alonso, R.D. Piner, D.H. Adamson, H.C. Schniepp, X. Chen, R.S. Ruoff, S.T. Nguyen, I.A. Aksay, R.K. Prud'homme, L.C. Brinson, Functionalized graphene sheets for polymer nanocomposites, *Nat.* Nanotechnol., 2008, 3, 327-331.

59. S. Stankovich, D.A. Dikin, G.H.B. Dommett, K.M. Kohlhaas, E.A. Stach, R. Piner, S.T. Nguyen, R.S. Ruoff, Graphene-based composite materials, Nature, 2006, 442, 282-286.

60. J.J. Liang, Y.F. Xu, Y. Huang, L. Zhang, Y. Wang, Y.F. Ma, F.F. Li, T.Y. Guo, Y.S. Chen, Infrared-triggered actuators from graphene-based nanocomposites. J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 9921-9927.

61. J.S. Bunch, A.M. van der Zande, S.S. Verbridge, I.W. Frank, D.M. Tanenbaum, J.M. Parpia, H.G. Craighead, P.L. McEuen, Electromechanical resonators from graphene sheets. Science, 2007, 315, 490–493.

62. S.E. Zhu, R. Shabani, J. Rho, Y. Kim, B.H. Hong, J.H. Ahn, H.J. Cho, Graphene-based bimorph microactuators, Nano Lett., 2011, 11, 977-981.

63. X.J. Xie, L.T. Qu, C. Zhou, Y. Li, J. Zhu, H. Bai, G.Q. Shi, L.M. Dai, An asymmetrically surface-modified graphene film electrochemical actuator, *ACS* Nano, 2010, 4, 6050-6054.
64. S. V. Ahir, E.M. Terentjev, Photomechanical actuation in polymer nanotube composites. Nat. Mater., 2005, 4, 491-495.

65. A.M. Fennimore, T.D. Yuzvinsky, W.Q. Han, M.S. Fuhrer, J. Cumings, A. Zettl, Rotational actuators based on carbon nanotubes, Nature, 2003, 424, 408-410.

67. R.H. Baughman, C. Cui, A.A. Zakhidov, Z. Iqbal, J.N. Barisci, G.M. Spinks, G.G. Wallace, A. Mazzoldi, D. De Rossi, A.G. Rinzler, Carbon nanotube actuators, Science, 1999, 284, 1340-1344.

68. Y.F. Lian, Y.X. Liu, T. Jiang, J. Shu, H.Q. Lian, M.H. Cao, Enhanced electromechanical performance of graphite oxide-nafion nanocomposite actuator, J. Phys. Chem. C, 2010, 114, 9659-9663.

69. K. Mukai, K. Asaka, T. Sugino, K. Kiyohara, I. Takeuchi, N. Terasawa, D.N. Futaba, K. Hata, T. Fukushima, T. Aida, Highly conductive sheets from millimeter-long single-walled



carbon nanotubes and ionic liquids: application to fast-moving, low-voltage electromechanical actuators operable in air, Adv. Mater., 2009, 21, 1582-1585.

70. F.P. Du, C.Y. Tang, X.L. Xie, X.P. Zhou, L. Tan, Carbon nanotube enhanced gripping in polymer-based actuators, J. Phys. Chem. C, 2009, 113, 7223.

71. S. Ashley, Artificial muscles, Solvent-Induced Phase-Inversion and Electrical Actuation of Dielectric Copolymer Films, Sci. Am., 2003, 289, 52-59.

72. G. Gu, M. Schmid, P.W. Chiu, A. Minett, J. Fraysse, G.T. Kim, S. Roth, M. Kozlov, S.M. Munoz, Y. Hara, T. Sakai, R. Yoshida, S. Hashimoto, Self-walking gel, Adv. Mater., 2007, 19, 3480-3484.

73. R. H. Baughman, Conducting polymer artificial muscles, Synth. *Met.,* 1996, 78, 339-353.

74. S. Bong, Y.R. Kim, I. Kim, S. Woo, S. Uhm, J. Lee, H. Kim, Electrochem. Commun. 2010, 12, 129-131.

75. R. Karthik, S. Thambidurai, Synthesis of RGO–Co doped ZnO/PANI hybrid composite for supercapacitor application, Mater. Electron, 2017, 28, 9836-9851.

76. M. .N. Nuraimi, H. Anuar, M. Maizirwan, S.M. Sapuan, M.U. Wahit , S. Zakaria,

Preparation of Durian Skin Nanofibre (DSNF) and Its Effect on the Properties of Polylactic Acid (PLA) Biocomposites, Sains Malaysiana, 2015, 44(11), 1551-1559.

77. S. Charoenvai, Durian peels fiber and recycled HDPE composites, Energy Procedia, 2014, 56, 539-546.

78. D. Sun, M. Wong, L. Sun, Y. Li, N. Miyatake, H. J. Sue, Purification and stabilization of colloidal ZnO nanoparticles in methanol, J. Sol-Gel Sci. Technol. 2007, 43, 237-243.



<mark>ป</mark>ระวัติผู้วิจัย

ชื่อ วัน เดือน ปีเกิด

นายสันติ ร<mark>ัตนวี</mark>รนนท์ 3 ตุลาคม พ.<mark>ศ. 252</mark>1

วุฒิการศึกษา

วุฒิ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์) <mark>ชื่อสถาบัน</mark> มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จการศึกษา 2547

สถานที่ทำงาน

สาขาศึกษาทั่วไป-วิท<mark>ยาศาสตร์ (ฟิสิกส์)</mark> คณะศิลปศาสตร์ พื้นที<mark>่ศาลายา</mark> มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี<mark>ราชมงค</mark>ลรัตนโ<mark>กสินท</mark>ร์ ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170

สาขาวิจัยที่สนใจ

ฟิสิ<mark>กส์วัสดุ,</mark> วัสดุศา<mark>สตร์, พ</mark>ลังงานทางเลือก

. บท<mark>คว</mark>ามที่เสนอในที่ประชุมวิชาการและผลงานวิจัย

- สันติ รัตนวีรนนท์ สุรพล ศรีแก้ว และ ภราดร ภักดีวานิช. 2545. "เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับ การเตรียมซิลิกาจากขี้เถ้าแกลบ" การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 12 มีนาคม 2547, บทคัดย่อ หน้า 163
- 2. Santi Rattanaveeranon, Surapol Srikaew and Paradorn Pakdeevanich. Improved method for the preparation of pure silicon from rice husk. The third Thailand materials science and technology conference, 10-11 August 2004 pp. 270-272.
- 3. S. Rattanaveeranon, R. Ruamnikhom and S. Pangmanayon. Growth of zinc oxide nanoparticles on graphene assembly using to detect of acetone concentrations., Key Engineering Materials., 2016 Vol. 675-676, pp. 125-129.
- P. Ekabutr, T. Ariyathanakul, S. Chaiyo, P. Niamlang, S. Rattanaveeranon, O. Chailapakul, P. Supaphol, Carbonized electrospun polyvinylpyrrolidone/metal hybrid nanofiber composites for electrochemical applications., Journal. 2017, Applied. Polymer. Sciences., 135, pp. 45639-45639.
- 5. S. Rattanaveeranon, S. Dumrongsil, K. Jiamwattanapong, Effect of latex rubber and rubber powder as an admixture on bending strength of cement mortars, 2019, Applied. Mech. Mater. 891, pp. 180-186.





ภาคผน<mark>วก ข.</mark> ข้อ<mark>มูลดิบสมบัติไฟฟ้</mark>าเคม<mark>ีของตั</mark>วเก็บประจุยิ่งยวด

Sample	Specific surface area	Total pore volume (cc/g)	Average pore size (nm)	C _{spl} (F/g)	C _{sp2} (F/g)	C _{sp3} (F/g)	Cav	SD(±)	E density (kW/kg)	P density (kW/kg)
Annealing in air (AA)	109.16	0.128	4.37	55.86	60.1	63.1	59.69	3.64	5.23	6.66
rGO	625.89	0.956	6.11	205.33	210.66	213.66	209.88	4.22	14.2	19.9
ZnO/rGO	94.25	0.852	3.54	314.06	318.24	320.24	317.51	3.15	14.58	21.51
ZnO	48.33	0.4398	56.9	90.11	92.22	94.22	92.18	2.06	10.26	19.78
CuO	250.12	0.159	131.4	217.79	219.58	219.58	218.98	1.03	11.94	14.1
CuO/rGO	489.67	0.122	3.47	226.33	228.66	228.66	227.88	1.35	15.56	17.58
ZnO/rGO : CuO/rGO	6 <mark>55</mark> .32	0.134	2.27	460.26	465.11	465.11	463.49	2.80	18.36	25.23

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลดิบของการวัดไฟฟ้าเ<mark>คม</mark>ีของสารตัวอย่าง

